

สำนักหอสมุดกลาง พระจอมเกล้าลาดกระบัง

เครื่องขยายกำลังแบบสวิตซิ่ง

SWITCHING POWER AMPLIFIER



โดย



ปริญญาโทฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2541

เลขหมู่.....
เลขทะเบียน.....33916
วัน, เดือน, ปี 2.0.0.ย. 2542

รับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

SWITCHING POWER AMPLIFIER

MR.PAK SANGSILA

MR.SUWAT PRANIT



Project Report Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

For the Bachelor's Degree

Department of Industrial Technology

Faculty of Engineering

King Mongkut's Institute of Technology Ladkrablang

1998

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญาานิพนธ์

เครื่องขยายกำลังแบบสวิตชิง

SWITCHING POWER AMPLIFIER

โดย

นายภาคย์ แสงศิลา

นายสุวัฒน์ ประนิตย์

ภาควิชา

เทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์นิกร สุขุมตันติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อนุมัติให้ปริญญาานิพนธ์ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

คณะกรรมการสอบปริญญาานิพนธ์

.....อาจารย์ที่ปรึกษา

(.....)

.....กรรมการ

(.....)

.....กรรมการ

(.....)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับควรใช้เฉพาะเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ในการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ (เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสาร) ครั้งที่มีการนำไปใช้

Project Report

SWITCHING POWER AMPLIFIER

By

MR.PAK SANGSILA

MR.SUWAT PRANIT

Department of

Industrial Technology

Advisor

ASSOCIATED PROFESSOR.NIKORN SUKUTAMATANTI

Accepted by the Faculty of Engineering, King Mongkut,s Institute of Technology ,
Ladkrablang in partial Fulfillment of the Requirement for the Bachelor's Degree.

Project Report Committee

.....Chairman
()

.....Committee
()

.....Committee
()

.....Committee
()

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หัวข้อปริญญาานิพนธ์

เครื่องขยายกำลังแบบสวิตชิง

SWITCHING POWER AMPLIFIER

โดย

นายภาคย์ แสงศิลา

นายสุวัฒน์ ประนิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์นิกร สุขุมตันติ

บทคัดย่อ

เครื่องขยายกำลังแบบสวิตชิง (Switching Power Amplifier) เป็นการขยายสัญญาณแบบ Class D ซึ่งอาศัยหลักการของ Pulse Width Modulation คือ การนำเอาคลื่นพาหะ (คลื่นสัญญาณสามเหลี่ยม) มาทำการ Modulate กับสัญญาณอินพุตโดยใช้ Voltage Comparator เปรียบเทียบสัญญาณสามเหลี่ยมกับสัญญาณอินพุตโดยเอาท์พุตที่ได้จะเป็น Pulse ที่มีความกว้างของสัญญาณเปลี่ยนไปตามขนาดของสัญญาณอินพุต

สัญญาณที่ได้จากการ Modulate จะถูกนำไปขับภาคเอาท์พุต ซึ่งทำงานในลักษณะของ Switching และนำสัญญาณจากภาคนี้มาผ่านวงจรกรองผ่านความถี่ต่ำต่อไปซึ่งจะได้สัญญาณเอาท์พุต ที่มีลักษณะเหมือนกับสัญญาณอินพุต

ข้อดีของวงจรขยายแบบ Class D คือ การสูญเสียของพลังงานจะมีน้อยโดยมีประสิทธิภาพเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

ส่วนข้อเสียของวงจรขยายแบบนี้คือ ต้องการวงจรกรองผ่านความถี่ต่ำที่ดีมากๆและ Switch ของกระแสสูงๆทำให้เกิดสัญญาณรบกวนขึ้นซึ่งเรียกว่า Electromagnetic Interference (EMI)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Project Report

SWITCHING POWER AMPLIFIER

By

MR.PAK SANGSILA

MR.SUWAT PRANIT

Advisor

ASSOCIATED PROFESSOR.NIKORN SUKUTAMATANTI

Abstract

A Class - D Amplifier is one which its fundamental component is a pulse – width modulator. By using a sawtooth generator and voltage comparator , a pulse-witch modulator can be constructed.

A Pulse – width modulator will produce a train of pulse having widths that are proportional to the level of the amplifier's input signal.

The output of pulse – witch modulator is used for driving the output stage of the class – D amplifier , causing it to switch on and off as the pulse switch between high and low.

The principle advantage of a class – D amplifier of that it may have a very high efficiency , approaching 100%

The principle disadvantage are the need for a very good low pass filter and the fact that high – speed switching of heavy currents generates noise through electromagnetic coupling , called , electromagnetic interference or EMI

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์เรื่องเครื่องขยายกำลังแบบสวิตซิ่ง (Switching Power Amplifier) ฉบับนี้สำเร็จ
ลุล่วงลงได้ โดยได้รับความร่วมมือ และคำแนะนำแนวทางในการทำโครงการเป็นอย่างดีจาก
รองศาสตราจารย์นิกร สุขุตมตันติ ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาเทคนิคอุตสาหกรรม และขอ
ขอบคุณการสื่อสารแห่งประเทศไทย (ไปรษณีย์กลางบางรัก) ที่ช่วยเหลือในด้านคำแนะนำและให้
ความอนุเคราะห์ในด้านเครื่องมือในการทดลอง

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้



นายภาคย์ แสงศิลา
นายสุวัฒน์ ประนิตย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ก
ABSTRACT	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทที่1 บทนำ	1
บทที่2 ภาคขยายกำลังแบบสวิตซิ่ง (Switching Power Amplifier)	5
2.1 วงจรใช้งานจริง	8
2.2 ภาคขยายกำลัง	11
บทที่3 เพาเวอร์มอสเฟต (Power Mosfet)	14
3.1 Steady – State Characteristic	17
3.2 Switching Characteristic	21
3.3 Gate Drive	23
บทที่4 ภาคจ่ายกำลังไฟแบบสวิตซิ่ง (Switching Power Supply)	25
4.1 การออกแบบวงจร	25
4.2 ส่วนของวงจรควบคุม	28

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

	หน้า
บทที่5 SOFTWARE	31
5.1 Control และ Object ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม	32
5.2 Event ที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรม	37
5.3 Method และ Property ที่ผู้ใช้เขียนโปรแกรม	39
5.4 ชนิดของ Operator	43
5.5 ขอบเขตของตัวแปร	45
5.6 การจัดการกับ File	46
บทที่6 ชิ้นงาน Switching Power Amplifier	47
6.1 Block Diagram	48
6.2 ส่วนของวงจร	49
6.3 การทดลองและแสดงผล	53
6.4 สรุปผลและวิจารณ์	61
หนังสืออ้างอิง	A
ภาคผนวก	B

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 1

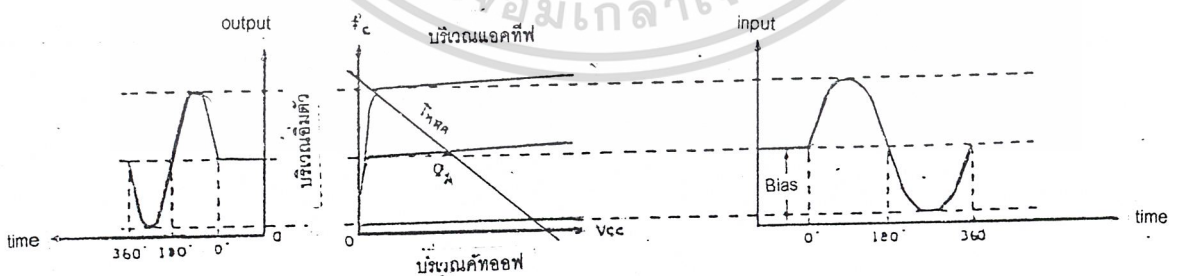
บทนำ

ในบทนี้ จะกล่าวถึงการขยายสัญญาณแบบต่างๆโดยย่อ เพื่อเปรียบเทียบข้อดีและข้อเสียของการขยายสัญญาณแบบต่างๆ เพื่อแสดงเหตุผลว่า ทำไมจึงเลือกใช้การขยายสัญญาณแบบ คลาสดี

เราอาจแบ่งการขยายกำลังออกเป็นคลาสต่างๆ ตามลักษณะของการไบแอสที่ให้แก่ทรานซิสเตอร์หรืออิกนัยหนึ่งตามตำแหน่งของจุดปฏิบัติการ Q (Quiescent point) บนโหลด แบ่งออกเป็น 4 แบบคือ

1.1) จุดปฏิบัติการ Q อยู่ในส่วนของ Active Region ซึ่งจะทำให้มีกระแสไหลผ่านตัวทรานซิสเตอร์ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีสัญญาณอินพุต หรือไม่ก็ตาม ทรานซิสเตอร์ จะนำกระแสตลอดช่วง 360 องศาของสัญญาณอินพุต การไบแอสในลักษณะนี้เรียกว่า คลาสเอ จะพบในส่วนที่ระดับของสัญญาณที่มีค่าต่ำๆประสิทธิภาพสูงสุดคือ 50 เปอร์เซ็นต์

ข้อดีของคลาสเอ คือมีความเพี้ยนต่ำกว่าคลาสอื่นๆทั้งนี้เพราะมีกระแสไหลผ่านตัวทรานซิสเตอร์ตลอด 360 องศาของสัญญาณอินพุต ทำให้กระแสคอลเลคเตอร์ ยังคงมีรูปร่างเป็นสัญญาณ Sine ที่สมบูรณ์

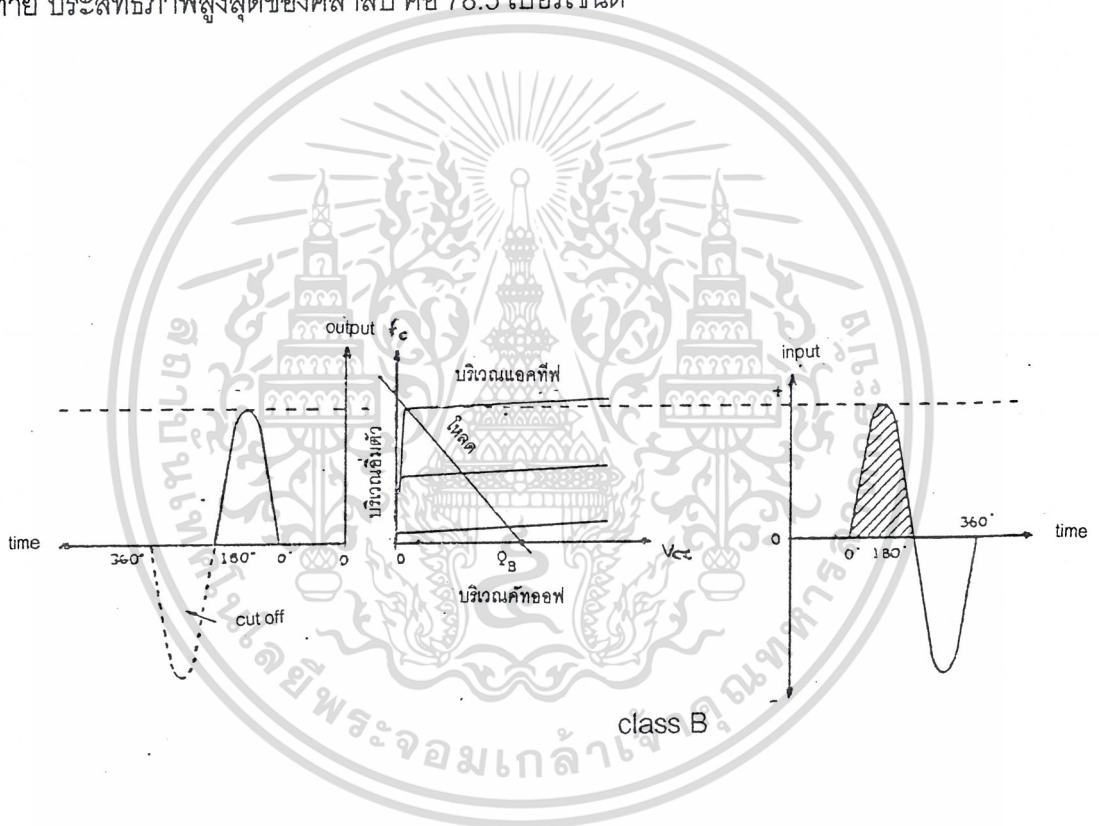


class A

รูปที่ 1 รูปคลื่นสัญญาณที่ได้จากการขยายกำลังแบบ คลาสเอ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

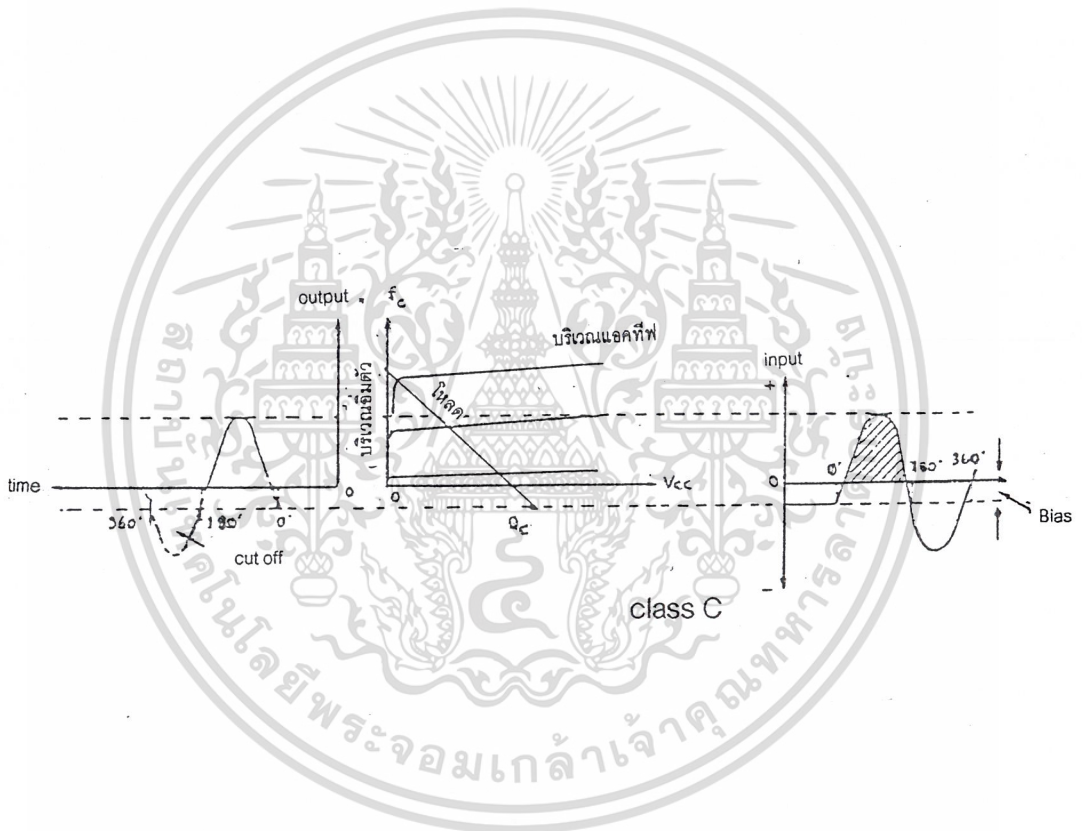
1.2) จุดปฏิบัติการ Q อยู่จุด Cutoff พอดี จะทำให้กระแสไหลผ่านตัวทรานซิสเตอร์ เฉพาะช่วงเวลาบางส่วนของซีกใดซีกหนึ่งของสัญญาณอินพุตเท่านั้นหรือทรานซิสเตอร์ จะนำกระแสในช่วง 180 องศาของสัญญาณอินพุต และในขณะที่ยังไม่มีสัญญาณอินพุต จะไม่มีกระแสไหลซึ่งทำให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น การไบอัสในลักษณะนี้คือ คลาสบี เนื่องจากมีกระแสไหลผ่านตัวทรานซิสเตอร์ เพียงซีกเดียวจึงต้องใช้ทรานซิสเตอร์ 2 ตัวสลับกันทำงานตัวละ 180 องศาของอินพุต เรียกการทำงานแบบนี้ว่า Push Pull เราจะพบวงจรคลาสบี ในส่วนที่ค่าสูงๆ เช่นภาคขยายภาคสุดท้าย ประสิทธิภาพสูงสุดของคลาสบี คือ 78.5 เปอร์เซ็นต์



รูปที่ 2 รูปคลื่นสัญญาณที่ได้จากการขยายกำลังแบบ คลาสบี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.3) จุดปฏิบัติการ Q อยู่ในส่วน cut off region ซึ่งจะทำให้มีกระแสไหลผ่านตัวทรานซิสเตอร์ เฉพาะช่วงเวลาบางส่วนของซีกใดซีกหนึ่งของสัญญาณอินพุต หรือทรานซิสเตอร์ จะนำกระแสในช่วงน้อยกว่า 180 องศาของสัญญาณอินพุต ในขณะที่ไม่มีสัญญาณอินพุต จะไม่มีกระแสไหลผ่านทรานซิสเตอร์ เรียกการไบอัส ในลักษณะนี้ว่าคลาสซี วงจรขยายคลาสซี นี้จะใช้งานได้เฉพาะความถี่ใดความถี่หนึ่งเท่านั้น เช่น ในส่วนการขยายกำลังของเครื่องส่งวิทยุประสิทธิภาพของคลาสซี ขึ้นกับจุดไบอัสและความถี่ที่ใช้งาน

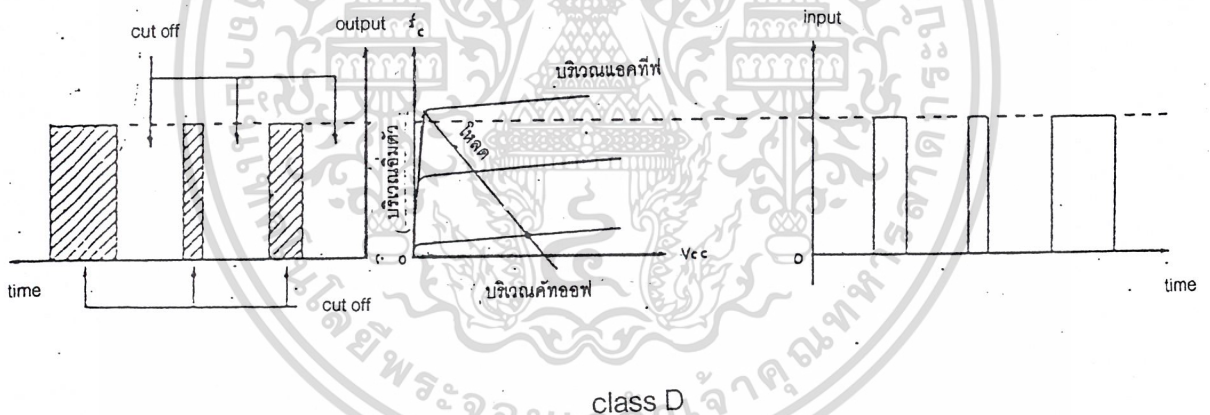


รูปที่ 3 รูปคลื่นสัญญาณที่ได้จากการขยายกำลังแบบ คลาสซี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1.4) ทรานซิสเตอร์ทำงานในลักษณะของสวิตช์ จุดปฏิบัติการจะอยู่ที่เดียวกับคราสปี แต่ ทรานซิสเตอร์ ในวงจรจะทำงานในลักษณะของสวิตช์ คือ นำกระแสอิ่มตัว (Saturate) กับไม่นำกระแส (Cut Off) กระแสที่ไหลผ่านตัวทรานซิสเตอร์ จะมีลักษณะเป็นพัลส์รูปสี่เหลี่ยม วงจรที่ทำงานในลักษณะเช่นนี้คือคลาสดี บางครั้งอาจเรียกว่าคลาสเอส วงจรคลาสดีอาจจะให้ประสิทธิภาพสูงถึง 90 เปอร์เซ็นต์

ข้อดีของการขยายกำลังแบบสวิตช์ก็คือมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงทำให้ประหยัดพลังงาน การสูญเสียที่ทรานซิสเตอร์น้อยลงเป็นผลทำให้แผ่นระบายความร้อนเล็กลงขนาดเครื่องก็จะเล็กลงน้ำหนักก็จะเบาขึ้น ซึ่งจะเหมาะสำหรับเครื่องที่ต้องการทำให้มีขนาดเล็ก และประหยัดพลังงาน



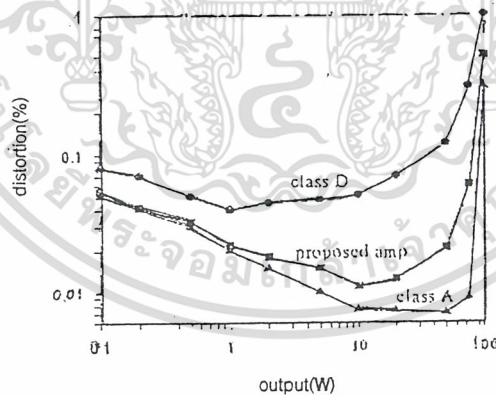
รูปที่ 4 รูปคลื่นสัญญาณที่ได้จากการขยายกำลังแบบ คลาสดี

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 2

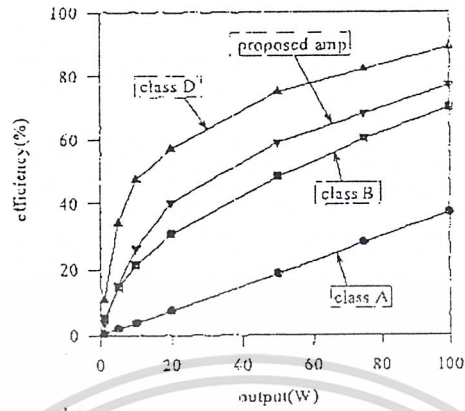
การขยายกำลังแบบสวิตชิง (Switching Power Amplifier)

ส่วนนี้เป็นส่วนที่สองของโครงการนี้ซึ่งเป็นส่วนขยายสัญญาณแบบสวิตชิง (แบบคลาสดี) ข้อแตกต่างของวงจรขยายแบบนี้คือเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ ที่เอาท์พุท นั้นจะทำงานเพียง 2 สถานะ คือ เปิด และ ปิด เท่านั้นซึ่งลักษณะการทำงานแบบนี้เมื่อเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ทำงาน (On) ค่าความต้านทานของเพาเวอร์ทรานซิสเตอร์ ใกล้เคียงกับ "0" และขณะที่เพาเวอร์ทรานซิสเตอร์หยุดทำงาน (Off) จะเสมือนความต้านทานมากๆ เข้าใกล้ไม่มีจำกัด ด้วยเหตุนี้การขยายกำลังแบบสวิตชิง จึงมีประสิทธิภาพสูงแต่ การขยายกำลังแบบสวิตชิง ก็ยังมีปัญหาอยู่ซึ่งก็คือการตอบสนองความถี่ และความเพี้ยนซึ่งค่อนข้างสูง

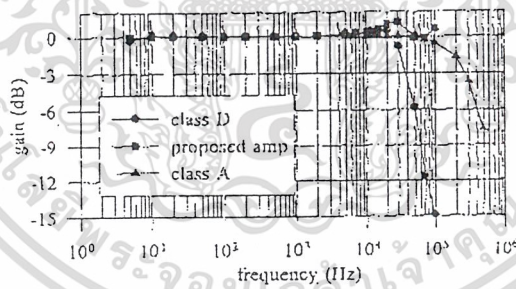


รูปที่ 1 แสดงถึงความเพี้ยนของสัญญาณเอาท์พุทเมื่อเปรียบเทียบระหว่างการขยายกำลังแบบสวิตชิงกับการขยายกำลังแบบคลาสอื่น ๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



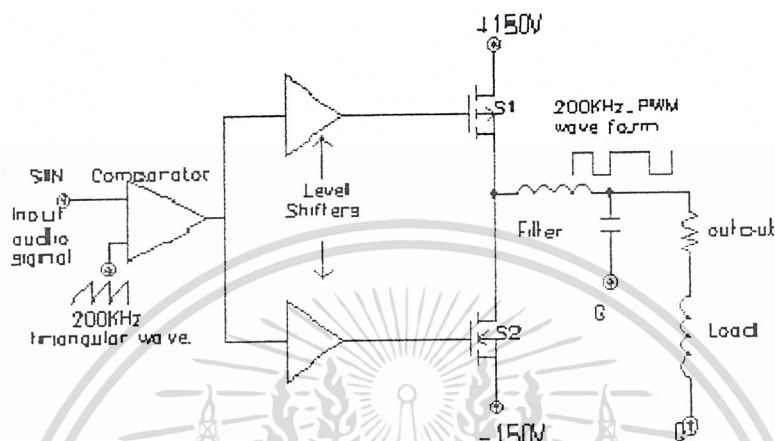
รูปที่ 2 แสดงถึงประสิทธิภาพของวงจรระหว่าง การขยายกำลังแบบสวิตชิง
กับการขยายกำลังแบบคลาสอื่นๆ



รูปที่ 3 แสดงถึงการตอบสนองความถี่ ของการขยายกำลังแบบสวิตชิง
กับการขยายกำลังแบบคลาสอื่นๆ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

จากรูปที่ 1 และ 2 จะพบว่าความเร็วของการขยายกำลังแบบสวิตชิง ค่อนข้างสูง แต่ประสิทธิภาพนั้น การขยายกำลังแบบสวิตชิง นั้นดีที่สุดเช่นเดียวกัน



รูปที่ 4 วงจรพื้นฐานสำหรับการขยายกำลังแบบสวิตชิง

จากรูปที่ 4 สามารถแบ่งวงจรขยายกำลังแบบสวิตชิงออกเป็น 4 ส่วนได้ดังนี้คือ

1) ภาค Pulse Width Modulator ใช้อปแอมป์ (Op Amp) เป็นตัวเปรียบเทียบ เพื่อเป็นตัวสร้างสัญญาณ Pulse Width Modulator โดยใช้สัญญาณสามเหลี่ยมเป็นพาหะ ในที่นี้วงจร ผลิตความถี่แบบสามเหลี่ยมใช้ ไอซีเบอร์ 4069 วงจรเปรียบเทียบใช้ ไอซีออปแอมป์ (Op Amp) แบบความเร็วสูงเบอร์ NE 538

2) Level Shifter เป็นวงจรขั้วขาเกท ของมอสเฟส

3) ภาคเพาเวอร์เอ๊าท์พุท ใช้มอสเฟสแบบสวิตชิงความเร็วสูง เบอร์ IRF 840 เป็น

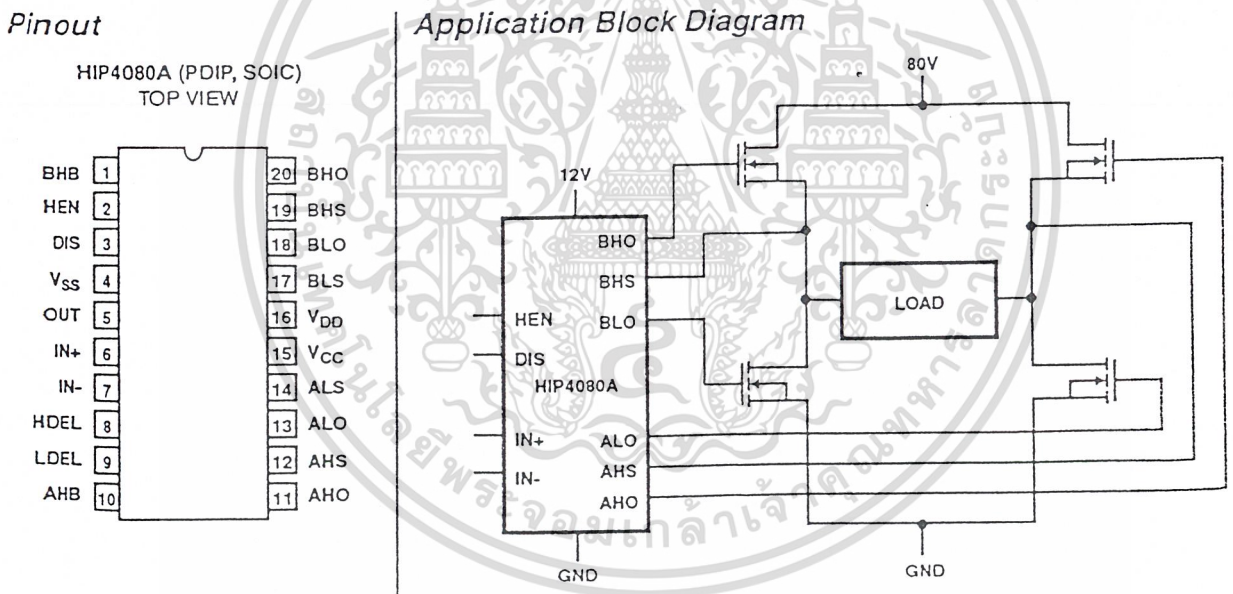
เอ๊าท์พุท

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

- 4) ภาควงจรของความถี่ต่ำผ่าน ทำหน้าที่กรองความถี่พาหะ ออกจากสัญญาณ เพื่อให้เอาต์พุต ที่ออกมาเสมือนกับอินพุต

2.1 วงจรที่ใช้งานจริง

ในโครงการนี้ ส่วนของภาคขับใช้ ไอซีเบอร์ HIP 4080 A ของบริษัท Harris ซึ่งมีตำแหน่งของการวางขาและหน้าที่ต่างๆดังนี้



รูปที่ 5 แสดงตำแหน่งของการวางขาภายในไอซีในส่วนของภาคขับ

ขาที่ 1 คือขา BHB ขานี้ต้องต่อกับขา Cathode ของไดโอดของ boot strap diode และขาด้านไฟบวกของตัวเก็บประจุ เพื่อยกระดับแรงดันที่ขานี้ให้สูงขึ้นถึงระดับ 12.8 โวลท์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขาที่ 2 คือขา HEN ย่อมาจาก High – side Enable ถ้าขานี้ได้รับลอจิก "0" จะทำให้ AHO และ BHO มีค่าต่ำ เมื่อขา HEN มีค่าสูงแล้วเท่านั้นจึงจะทำให้ขาเอาต์พุต ของไอซี ถูกควบคุมด้วยอินพุต

ขาที่ 3 คือขา DIS เป็นขา Dis enable เมื่อขานี้ได้ลอจิก " 1 " จะทำให้เอาต์พุต ทุกขา ของ HIP 4080 set เป็นค่า " 0 " เมื่อขา DIS ได้รับลอจิก " 0 " จะให้เอาต์พุต ถูกควบคุมด้วยอินพุต

ขาที่ 4 คือขา VSS เป็นไฟเลี้ยงด้านลบของวงจรจ่ายไฟลบเข้าที่ขา

ขาที่ 5 คือขาออกเป็นขาที่พัลส์วิดท์มอด ของไอซีออกมาโดยไม่มีกรนวนงเวลา

ขาที่ 6 คือขา In^+ เป็นอินพุต ด้านบวกของไอซี ถ้าขานี้ได้รับแรงดันซึ่งสูงกว่าขา In^- แล้วจะให้เอาต์พุต ที่ขา ALO และ BHO เป็น Low ส่วนขา BLO และ AHO มีเอาต์พุต เป็น High

ขาที่ 7 คือขา In^- เป็นอินพุต ด้านลบของไอซี มีลักษณะการทำงานที่ตรงข้ามกับขาที่ 6

ขาที่ 8 คือขา HDEL ย่อมาจาก High side turns – on delay ขานี้ต่อความต้านทานลงกราวด์เพื่อกำหนดค่า Dead Time ของวงจร (ดูได้จากภาคผนวก)

ขาที่ 9 คือขา LDEL ย่อมาจาก Low side turns – on delay ขานี้ต่อความต้านทานลงกราวด์เพื่อกำหนดค่า Dead Time ด้านลบของวงจร (ดูได้จากภาคผนวก)

ขาที่ 10 คือขา AHB คือขา A high – side boot strap supply ต่อไดโอด ที่ขา^{นี้}และต่อตัวเก็บประจุ ลงกราวด์เพื่อยกระดับแรงดันให้เพิ่มขึ้นจนถึงระดับ 12.8 โวลต์ ลักษณะการต่อขานี้ เช่นเดียวกับขา BHB

ขาที่ 11 คือขา AHO เป็นขาที่ A high – side output เป็นขาซึ่งขับขาเกท ของ มอสเฟต ด้าน High ของภาคขยายกำลัง

ขาที่ 12 คือขา AHS ย่อมาจาก A high - side source connection ต่อขานี้ไปที่ขา source ของมอสเฟต ชุต A และต่อที่ด้านลบของตัวเก็บประจุซึ่งใช้ยกกระดับแรงดัน

ขาที่ 13 คือขา ALO ย่อมาจาก A low – side output ขานี้ต่อไปที่ขาเกท ของ

มอสเฟตชุต A ด้าน Low

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ขาที่ 14 คือขา ALS ย่อมาจาก A low side source connection ต่อขาขึ้นไปที่ขา source ของมอสเฟตชุด A ด้านโพลบ

ขาที่ 15 คือขา VCC เป็นขาซึ่งรับไฟเลี้ยงมาเลี้ยงไอซี ในที่นี้ใช้ 12 โวลท์

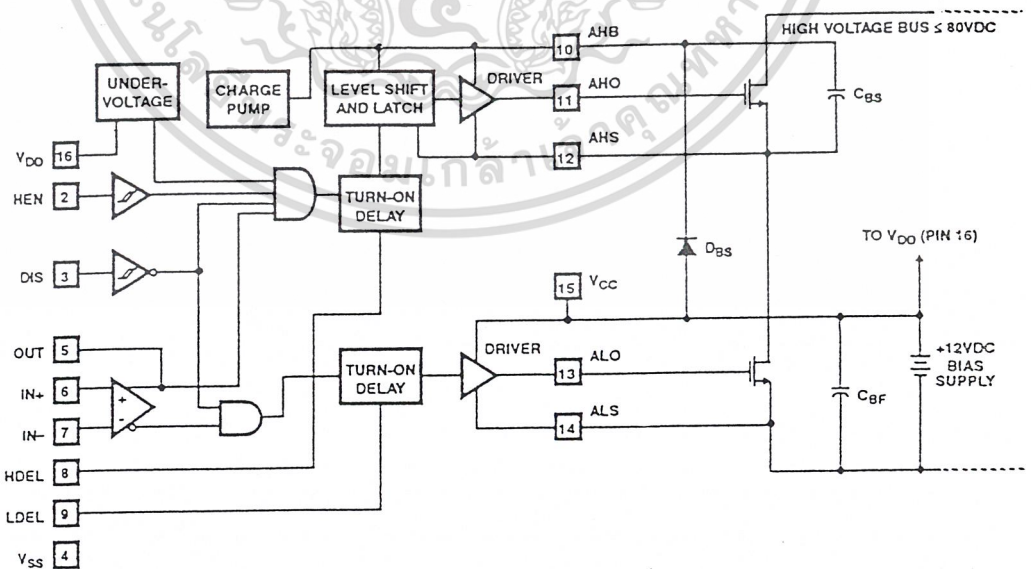
ขาที่ 16 คือขา VDD ต่อขาขึ้นไปที่ไฟเลี้ยงเช่นเดียวกับขา 15

ขาที่ 17 คือขา BLS ย่อมาจาก B low – side source connection ต่อขาขึ้นไปที่ขา source ของมอสเฟต ชุด B ด้านโพลบ

ขาที่ 18 คือขา BLO คือขา B Low – side Output ขานี้ต่อไปที่ขาเกท ของมอสเฟต ชุด B ด้าน Low

ขาที่ 19 คือขา BHS ย่อมาจาก B high – side source connection ขานี้ต่อไปที่ขา Source ของมอสเฟตชุด B ด้าน High

ขาที่ 20 คือขา BHO ย่อมาจาก B high – side Output ต่อขาขึ้นไปที่ขาเกทด้าน High ส่วนวงจรภายในไอซี นั้นถ้าเทียบกับวงจรพื้นฐานแล้วจะเห็นได้ว่าที่ขา 6 และขา 7 จะเป็นอินพุต ของวงจรเปรียบเทียบ ส่วนวงจรยกระดับนั้น เปรียบเทียบได้กับวงจร Turn On Delay และ Level Shifter เช่นเดียวกัน ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะว่าถ้าหากกำหนดไม่ดีจะทำให้มอสเฟต เปิดและปิด ผิดไปจะเกิดความเสียหายขึ้นได้



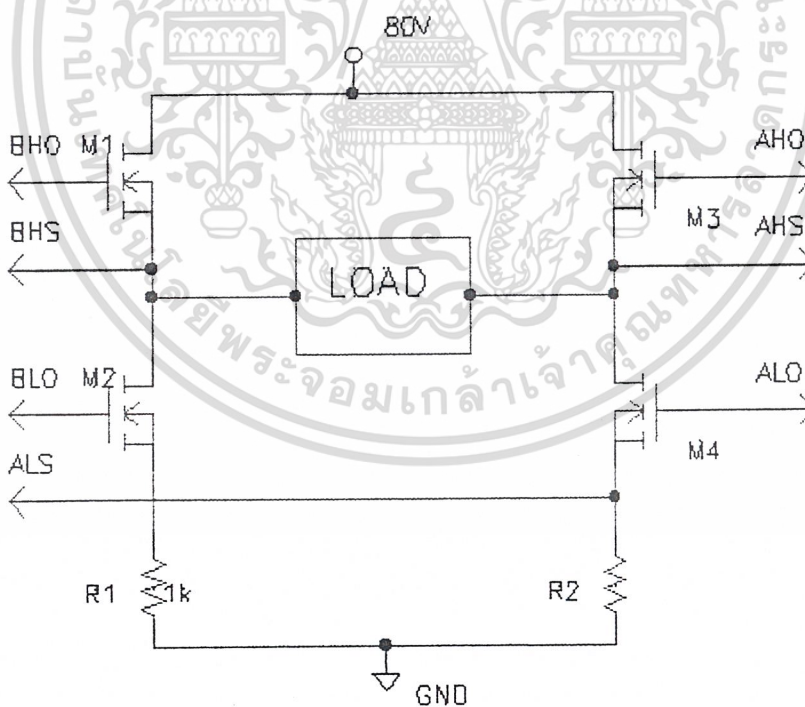
รูปที่ 6 แสดงการจัดโครงสร้างภายในไอซีในส่วนของภาคขับ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ทางด้านของวงจรกำลังนั้นรูปแบบวงจรอาจต่างจากวงจรพื้นฐานเพราะว่าวงจรพื้นฐานจัดวงจรแบบ Half Bridge ส่วนวงจรที่ใช้งานนั้นผู้จัดทำจัดวงจรแบบ Full Bridge แต่หลักการในการสวิตช์ นั้นเหมือนกัน สาเหตุที่ต้องใช้วงจรภาคกำลังเป็นแบบ Full Bridge นั้นเนื่องจากไอซีที่ใช้ขับนี้ออกแบบมาเพื่อขับวงจรแบบ Full Bridge โดยเฉพาะ ส่วนรายละเอียดในการจัดวงจรภาคกำลังเป็นดังนี้

2.2 ภาคขยายกำลัง

เนื่องจากภาคขยายกำลังนี้เป็นแบบ Nonlinear ซึ่งวงจขยายจะมี 2 สถานะเท่านั้นคือ คัดออกฟ กับ อิมิตัว ซึ่งการจัดวงจรในที่นี้ผู้จัดทำได้ใช้วงจรคอนเวอเตอร์ แบบ Full Bridge โดยที่มีวงจรพื้นฐานดังนี้



รูปที่ 7 วงจรภาคขยายกำลัง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

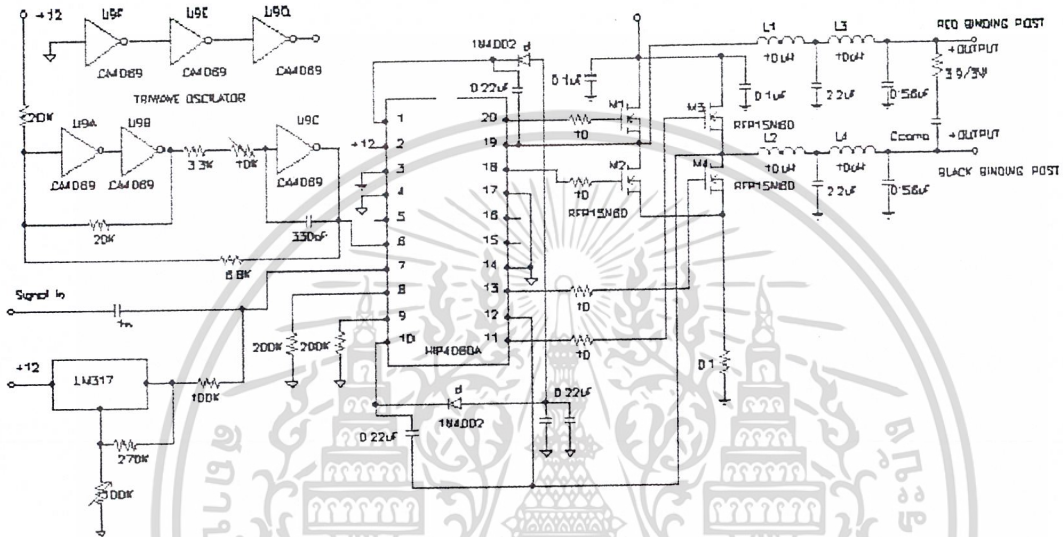
จากรูปการทำงานของวงจรมอดูเลชันเฟส ต้อง เปิด พร้อมกันทั้ง 2 ตัว และ ปิด พร้อมกันทั้ง 2 ตัว นั่นคือ Q1 จะทำการ เปิด และ ปิด พร้อมๆกับ Q4 ส่วน Q2 และ Q3 ก็จะทำ การ เปิด และ ปิด พร้อมๆกันเช่นเดียวกัน ถ้าเกิดเกิดความผิดพลาดขึ้นในวงจร ภาคขับ แล้วทำให้ Q1 เปิด พร้อมๆกับ Q2 หรือ Q3 เปิดพร้อมๆกับ Q4 แล้วจะทำให้วงจรมอดูเลชันเฟสเกิดการเสียหายขึ้นได้ เนื่องจากกระแสจะไหลผ่าน Q1 และ Q2 ลงกราวด์โดยตรง หรือในอีกกรณีคือ Q1 กับ Q4 เปิด พร้อมๆกันขณะที่ Q2 หรือ Q3 ยังไม่ปิด ก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้เช่นเดียวกัน ในกรณีที่ใช้ความถี่สูงๆในการ สวิตซ์ นั้น สัญญาณข้อมูลจะอยู่ในความกว้างของสัญญาณ Pulse Width Modulator เมื่อต้องการนำข้อมูลกลับมา เราต้องผ่านวงจรกรองความถี่ต่ำผ่านซึ่งใช้ 2 ชุดเป็นตัวกรองความถี่ ก่อนเข้าสู่ลำโพง มอสเฟตที่ใช้ต้องเป็นมอสเฟตที่ใช้ในการสวิตซ์ความถี่สูง

ในส่วนที่ใช้ในโครงการนี้ได้ใช้มอสเฟต เบอร์ RFP 15N 60 เป็นตัวสวิตซ์ ในวงจรที่ขา เกท ของมอสเฟตทั้ง 4 ตัวมีความต้านทาน 10 โอห์ม ต่ออยู่เพื่อป้องกันการผลิตความถี่ ของ มอสเฟตในส่วนของวงจรมอดูเลชันเฟสผู้จัดทำได้ใช้แผงวงจรพิมพ์ 2 หน้า ด้านที่วางอุปกรณ์ได้ทำเป็นแผ่นตัว นำ แผ่นกราวด์เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนซึ่งการขยายกำลังแบบสวิตซ์ตัวนี้เมื่อทำงานแล้วจะมี สัญญาณรบกวนมากเนื่องจากความถี่ที่ใช้ในการสวิตซ์มีความถี่สูงและไม่เป็นสัญญาณ Sine ทำให้มีสัญญาณรบกวนสูงมาก

หมายเหตุ ภาคอินพุต ของวงจรมอดูเลชันเฟสได้มีการเพิ่มวงจรกรองความถี่ต่ำ ผ่านที่ Cut Off Frequency เท่ากับ 20 กิโลเฮิร์ต เพื่อลดสัญญาณรบกวนที่ไม่จำเป็นและกรอง สัญญาณรบกวนทิ้งไป อีกทั้งวงจรเป็นแบบ Active Filter ทำให้มี Gain ในการขยายสัญญาณให้มีแรงดันเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากสัญญาณพาหะ ที่ได้จากวงจรมอดูเลชันเฟสมีความถี่สูงซึ่ง ถ้าหากต้องการเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ป้อนให้แล้วนั้น ต้องทำการขยายแรงดันเพื่อให้แรงดัน จากข้อมูลใกล้เคียงกับสัญญาณพาหะ

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้拿去ใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคขับของการขยายกำลังแบบสวิตชิง



รูปที่ 8 วงจรสมบรูณ์ของภาคขยายกำลังแบบสวิตชิง

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 3

เพาเวอร์มอสเฟต (Power mosfet)

เป็นอุปกรณ์ควบคุมสวิตช์ดาไฟฟ้าและต้องการเพียงกระแสอินพุต ที่มีขนาดเล็กๆเท่านั้น ความเร็วในการสวิตช์ซึ่งมีค่าสูงมากดั่งนั้นเวลาในการสวิตช์ซึ่ง อยู่ในหน่วย Nanoseconds การประยุกต์ใช้งานของ เพาเวอร์มอสเฟต จะใช้งานเป็นคอนเวอเตอร์ความถี่สูง และ มอสเฟตนั้นไม่มีปัญหาของปรากฏการณ์ Breakdown เช่น Bipolar Junction Transistor (BJT) แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาของมอสเฟต จะอยู่ที่ Electrostatics Discharge และเป็นการยากที่จะป้องกันมอสเฟตจากความผิดพลาดที่เกิดจากการลัดวงจร

MOSFETs มี 2 ชนิด

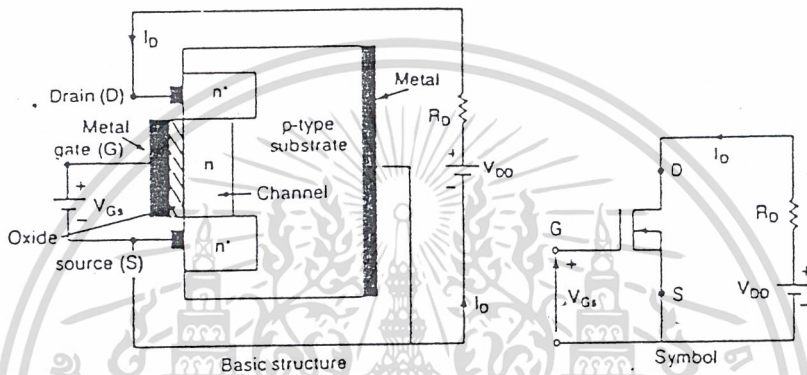
- 1) Depletion MOSFET
- 2) Enhancement MOSFET

1) Depletion MOSFET ที่ N-Channel Depletion-Type MOSFETตามรูปที่ 1 ที่แชนเนล n จะคล้าย P-Type Silicon Substrate และประกอบด้วย n^+ Silicon เพื่อต่อเป็นค่าความต้านทานต่ำที่ เกท นี้จะถูกแยกออกมาจากแชนเนล ด้วยชั้นของออกไซด์บางๆมอสเฟต นี้ประกอบด้วยขั้ว 3 ขั้ว เรียก เกท เดรน และ ซอร์ส โดยปกติให้ศักดาไฟฟ้าลบบต่ออยู่กับซอร์ส โดยค่าศักดาไฟฟ้าที่ขั้ว เกท และซอร์ส คือ V_{gs} ทั้งนี้ค่าของ V_{gs} เป็นได้ทั้งบวกและลบ

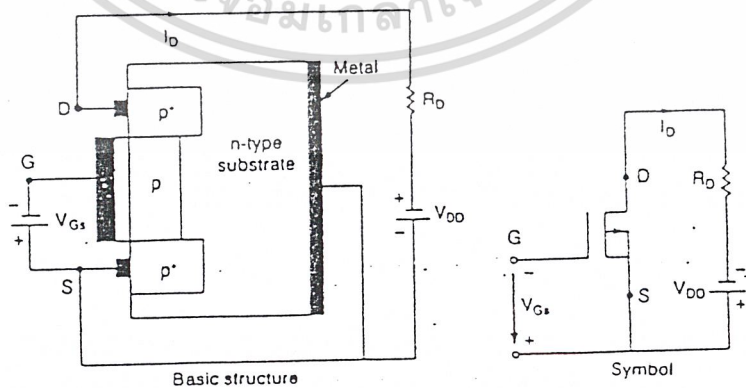
ที่ P-Channel Depletion-Type MOSFET ตามรูปที่ 2 ถ้า V_{gs} เป็นลบ อิเล็กตรอนจำนวนหนึ่งใน P-Channel จะ Repel และชั้นของ Depletion Region จะสร้างชั้นออกไซด์บางๆและทำให้เกิดช่องแคบๆมีความต้านทานสูงจากขั้ว เดรน ไปยังซอร์ส (R_{ds}) ถ้า V_{gs} มีค่าเป็นลบเพียงพอที่แชนเนลจะกลายเป็นช่องว่าง และทำให้ไม่มีกระแสไหลจาก เดรน ไปยัง ซอร์ส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ดังนั้น $V_{gs} = 0$ และเราเรียกค่าของ V_{gs} ปรากฏการณ์นี้ว่า Pinch - Off Voltage (V_p) ถ้า V_{gs} เป็นบวกที่เซนแนลจะกว้างขึ้นและค่าของ I_{ds} จะมีค่าเพิ่มขึ้นเนื่องจาก R_{ds} มีค่าลดลงทำให้ P-Channel Depletion-Type MOSFETs โดยค่าของ V_{ds} , I_{ds} , V_{gs} จะ Reverse กัน



รูปที่ 1 N-Channel Depletion-Type MOSFET

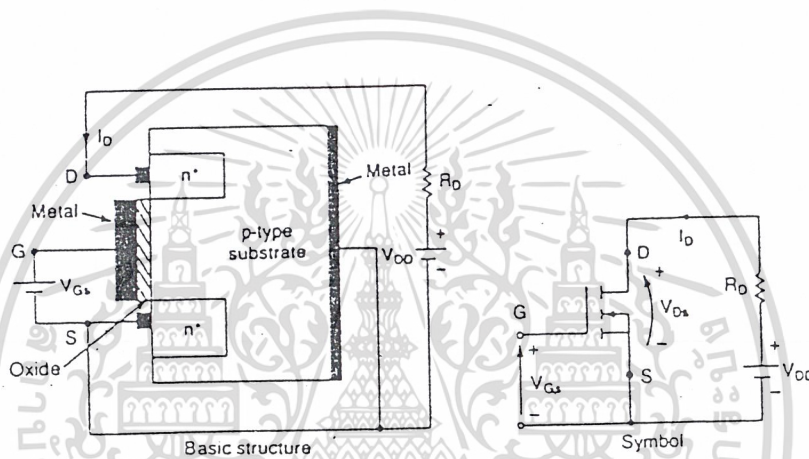


รูปที่ 2 P-Channel Depletion-Type MOSFET

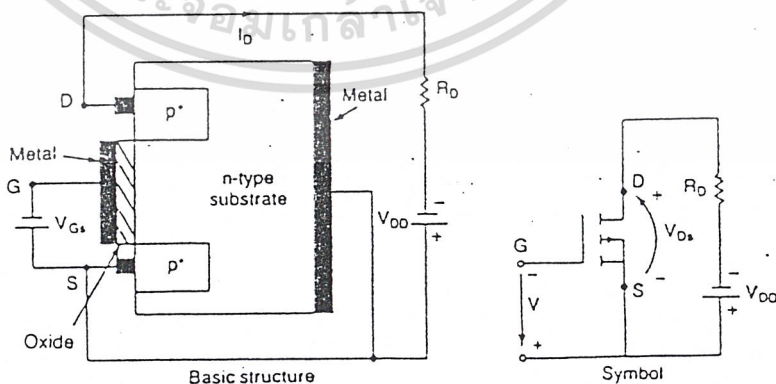
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับครูใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

2) Enhancement MOSFET

ถ้า V_{gs} เป็นค่าบวก Induced Voltage จะต้านทานอิเล็กตรอนจาก P-Substrate และถ้า V_{gs} มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ Threshold Voltage (V_t) ปริมาณกระแสจะไหลจากขั้วเดรน ไปยัง ซอร์ส และสำหรับ P-Channel Enhancement-Type MOSFETs จะได้ว่าค่าของ V_{gs} , V_{ds} , I_{ds} เป็น Reverse กัน



รูปที่ 3 N-Channel Depletion-Type MOSFET



รูปที่ 4 P-Channel Depletion-Type MOSFET

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่ต่อแบบสงวนเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.1 Steady-State Characteristics

เนื่องจากมอสเฟต เป็นอุปกรณ์แบบ Voltage-Controlled และมีอินพุต Impedance สูงมากๆ โดยที่ Gate Draws มีกระแสรั่วไหลเพียงเล็กน้อย (ในหน่วย nanoampere) ค่าของ Current Gain เป็นอัตราส่วนระหว่างกระแสเดรน (Drain Current , I_d) กับกระแสอินพุต

$$\text{Current Gain} = \frac{\text{Drain Current}}{\text{Input Gate Current}}$$

แต่อย่างไรก็ตามค่าของ Current Gain ยังไม่ใช่ค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญค่าของ Transconductance ซึ่งเป็นอัตราส่วนระหว่างกระแสเดรน (Drain Current) กับค่าของความต่างศักย์ที่เกต (Gate Current)

$$\text{Transconductan} = \frac{\text{Drain Current}}{\text{Gate Voltage}}$$

และพบว่าค่าของ Transconductance เป็นค่าพารามิเตอร์ที่สำคัญ The Transfer Characteristics ของ N-Channel ของมอสเฟต แสดงตามรูปที่ 5 และรูปที่ 6 แสดง Output Characteristics ของ N-Channel Enhancement MOSFETs และมีย่านการทำงาน 3 ช่วงคือ

1. ย่าน Cutoff Region $V_{gs} \leq V_t$
2. ย่าน Pinch Off Region หรือ Saturation Region $V_{ds} \geq V_{gs} - V_t$
3. ย่าน linear Region $V_{ds} \leq V_{gs} - V_t$ ในย่าน Linear Region ค่าของกระแส

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เดรน แปรผันกับค่า Drain Source Voltage (V_{ds}) เนื่องจากกระแสเดรนสูงและศักดาเดรนต่ำ
ทรานซิสเตอร์กำลังมีการทำงานแบบสวิตชิ่งในช่วง Linear Region ในย่าน Saturation
Region ค่ากระแสเดรนที่ยังเหลือจะเป็นค่าคงที่โดยจะมีการเพิ่มเพียงเล็กน้อยในค่าของ V_{ds} และ
การใช้งานของทรานซิสเตอร์ในย่านนี้จะนำไปใช้ประโยชน์เป็น Voltage Amplification

รูปแบบการ Steady – State ซึ่งทั้ง Depletion-Type และ Enhancement-Type
MOSFETs แสดงในรูป 5 ค่าของ Transconductance (g_m) กำหนดโดย

$$g_m = \frac{\Delta I_d}{\Delta V_{gs}} \Big|_{V_{ds} = \text{Constant}}$$

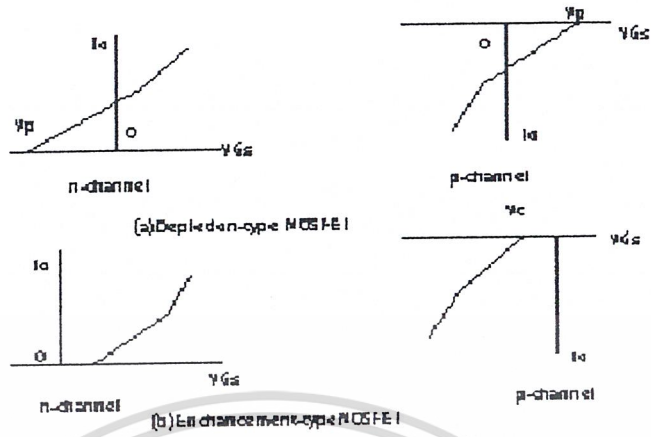
ค่าความต้านทานด้านเอาต์พุต

$$r_o = R_{ds}$$

$$R_{ds} = \frac{\Delta V_{ds}}{\Delta I}$$

ซึ่งจะมีค่าสูงมากๆในย่าน Pinch-Off (Megaohms) และจะมีค่าน้อยมากๆในย่าน
Linear Region (Milliohms)

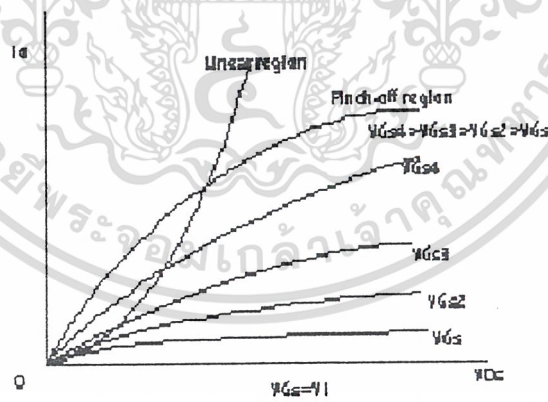
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 5 Transfer Characteristic Of MOSFETs

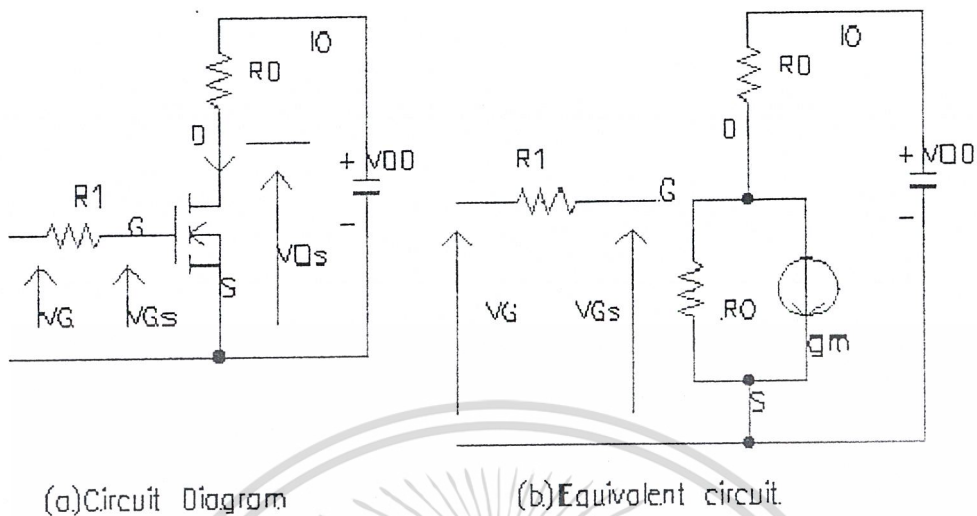
(a) Depletion-Type MOSFETs

(b) Enhancement-Type MOSFETs



รูปที่ 6 Output Characteristic Of Enhancement-type MOSFETs

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 7 Steady-state Switching Model of MOSFETs

(a) Circuit Diagram

(b) Equivalent Circuit

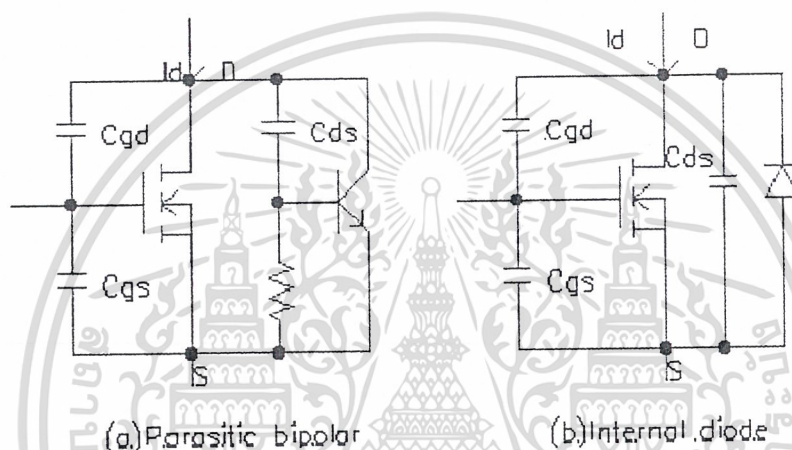
สำหรับ Depletion-Type MOSFETs ค่าของ Gate (หรืออินพุต) จะเป็นบวกหรือลบก็ได้แต่ใน Enhancement-Type MOSFETs ศักไฟฟ้าที่ Gate จะเป็นบวกเท่านั้น

มอสเฟตกำลังโดยปกติจะเป็นชนิด Enhancement Mode อย่างไรก็ตาม Depletion-Type MOSFETs จะมีประโยชน์และง่ายต่อการออกแบบวงจรลอจิกซึ่งในทางปฏิบัติต้องการค่าไฟกระแสตรง หรือ สวิตช์แบบกระแสกลับ ซึ่งจะเหลืออยู่ขณะมีลอจิก Supply จะตกลงและ V_{gs} กลับเป็นศูนย์

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.2 Switching Characteristics

เมื่อไม่มีสัญญาณเกต Enhancement-type MOSFETs เราจะพิจารณาเป็น ไดโอด 2 ตัวต่อแบบ Parasitic Capacitances ต่อแบบ Source C_{gs} และ Drain , C_{gs} ทหารานซิสเตอร์ชนิดเอ็นพีเอ็น เป็นรอยต่อแบบ Reverse Bias จากเดรน ไปยังซอร์ส C_{ds}

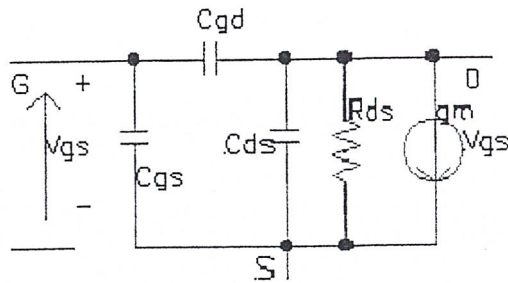


รูปที่ 8 Parasitic Model of Enhancement-type MOSFETs

(a) Parasitic Bipolar

(b) Parasitic Diode

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 9 Switching Model of MOSFETs

รูปที่ 8a แสดงวงจรสมมูลย์ของ Parasitic Bipolar Transistor ที่ต่อขนานกับ มอสเฟต จุดที่เบสต่อกับอิมิตเตอร์ของทรานซิสเตอร์ ชนิด เอ็นพีเอ็น จะสั้นและมีค่าความต้านทานจากเบส ไปยัง อิมิตเตอร์ เนื่องจาก Bulk Resister ของชนิดเอ็นและพี (R_{be}) มีขนาดเล็กมาก ดังนั้น มอสเฟต อาจพิจารณาจากวงจรสมมูลย์ดังแสดงในรูป 8b

ค่า Parasitic Capacitance ขึ้นอยู่กับ Respective Voltage วงจรลิตซึ่งของมอสเฟต ดังแสดงในรูปที่ 9 โดย Waveforms จะแสดงในรูปที่ 10

Turn-On Delay , $t_d(on)$ เป็นเวลาที่ต้องการ Charge Input Capacitance จน ถึง Threshold Voltage Level

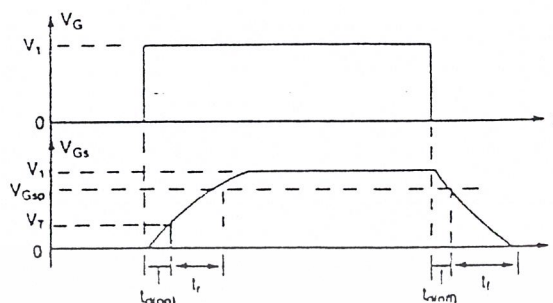
Rise Time , t_r เป็นเวลาที่ต้องการ จากระดับ Threshold Level สู่ Full-Gate Voltage V_{gs} เมื่อต้องการขับกระแสทรานซิสเตอร์ เข้าไปยังบริเวณ Linear Region

Turn-Off Delay Time , $t_d(off)$ เป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการ Discharge จาก Over Drive Gate Voltage เข้าสู่บริเวณช่วง Pinch-Off Region โดยค่าของ V_{gs} ต้องลดลงก่อนที่ค่าของ V_{ds} จะเริ่มต้นเพิ่มขึ้น

Fall-Time t_f เป็นช่วงเวลาที่ใช้ในการ Discharge

จากช่วง Pinch Off เข้าสู่ Threshold Voltage ถ้า $V_{gs} \leq V_t$ ทรานซิสเตอร์ก็จะ Turn Off

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 10 Switching Waveform and Times

3.3 Gate Drive

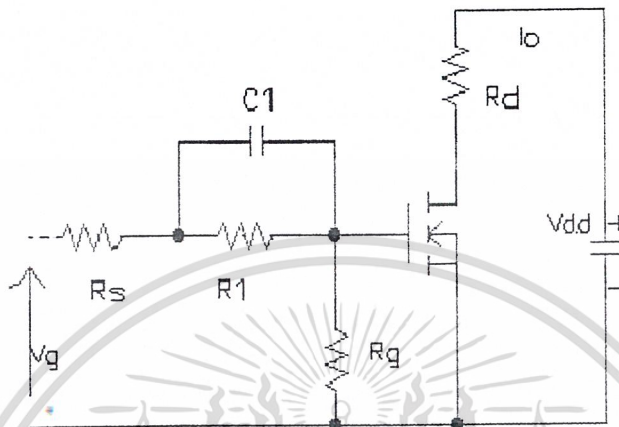
เวลาในการ Turn Off ของมอสเฟต ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในการชาร์จ ประจุของอินพุต หรือ Gate Capacitance โดยช่วงเวลาในการ Turn Off นี้จะลดลงได้โดยทำการต่อวงจรความต้านทานและตัวเก็บประจุเข้าไปโดยได้แสดงไว้ในรูปที่ 9 เพื่อทำการ Charge Gate Capacitance ให้เร็วขึ้น เมื่อ Gate Voltage Turn-on กระแสเริ่มต้นในการ Charging ของ Capacitance คือ

$$I_g = \frac{V_g}{R_s}$$

และค่า Steady-State ของศักดาไฟฟ้าที่ Gate คือ

$$V_{gs} = \frac{(R_g \cdot V_g)}{(R_s + R_l + R_g)}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารสงวนลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ห้ามนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่ 11 Fast-Turn-On Gate Circuit

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 4

ภาคจ่ายไฟแบบสวิตชิง (Switching Power Supply)

ส่วนแรกนี้เป็นวงจรจ่ายกำลังงานให้กับเครื่องขยายกำลังแบบสวิตชิง (Switching Power Amplifier) อีกทีหนึ่ง การออกแบบวงจรเป็นแบบ Half Bridge Converter ที่ความถี่ 25 กิโลเฮิร์ต แรงดันอินพุต ประมาณ 311 V_{dc} ให้เอาท์พุต ประมาณ 35,0,35 โวลท์ กำลัง 100 วัตต์ 3 แอมป์ วงจรควบคุมใช้วงจรควบคุมในโหมด แรงดันใช้ไอซี TL 494 เป็นตัวควบคุม

4.1 การออกแบบวงจร

การออกแบบเริ่มจากการกำหนดแรงดันเอาท์พุต ที่ต้องการ กำลังที่ต้องการจากคอนเวอเตอร์ ก่อนในที่นี่ต้องการจากคอนเวอเตอร์ จำนวน 100 วัตต์ ที่ความถี่ 25 กิโลเฮิร์ต แรงดันจาก Line 220 Vac เป็นแรงดันที่ป้อนให้วงจรขยายกำลังแบบสวิตชิง 35,0,35 โวลท์ เมื่อได้เงื่อนไขต่างๆแล้วจึงทำการเลือกว่าจะใช้คอนเวอเตอร์ ชนิดใด ในที่นี้เลือก Half Bridge Converter เนื่องจากทรานซิสเตอร์แบบกำลัง ที่เอาท์พุต มีแรงดันตกคร่อมเท่ากับแรงดันที่จ่ายให้วงจรซึ่งแรงดันไม่สูงมากนัก (311 โวลท์ ขณะ Cut off) ดังนั้นทรานซิสเตอร์ จึงหาง่ายและราคาถูกกว่าคอนเวอเตอร์ ชนิดอื่นๆ

ขั้นตอนการออกแบบ

1. หาคาบเวลาการทำงานจากความถี่ 25 KHz

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{25 \times 10^3} = 40 \times 10^{-6} \text{ วินาที}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 2. กำหนดค่า $T_{on \max} = 0.4 T$
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหา และต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

สาเหตุที่ทำให้การกำหนดค่า $T_{on(max)}$ ประมาณ $0.4 T$ เนื่องจาก Half Bridge Converter นี้ใช้ ทรานซิสเตอร์แบบกำลัง 2 ตัว เปิด พร้อมกันจะทำให้กระแสไหลผ่านทรานซิสเตอร์ ทั้งสองทำให้พังเสียหายได้จึงต้องกำหนดค่าเวลาประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ของช่วงเวลาที่ทำการเปิด เพื่อป้องกัน การ เปิด พร้อมกันของทรานซิสเตอร์ (ช่วงเวลานี้เรียกว่า Dead time)

$$T_{on(max)} = 0.4 \times 40 \times 10^{-6} = 16 \times 10^{-6} \text{ วินาที}$$

3. กำหนดค่า N_p / N_s จากสูตร

$$\begin{aligned} \frac{N_p}{N_s} &= \frac{(V_{in(min)} / 2 - V_{ce(sat)}) \times T_{on(max)}}{(V_{od} + V_d) \cdot (T/2)} \\ &= \frac{((314/2) - 1) \times 16 \times 10^{-6}}{(35 + 1) \cdot (40 \times 10^{-6} / 2)} \\ &= 3.433 \end{aligned}$$

4. กำหนดจำนวนรอบของขดลวด

$$\begin{aligned} N_p &= \frac{(V_{in(min)} / 2 - V_{ce(Sat)}) \times T_{on(Max)} \times 10^8}{\Delta B_{max} \cdot A_e} \\ &= \frac{(311/2) - (1 \times 16 \times 10^{-6}) \times 10^8}{1600 \times 1.48} \end{aligned}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ΔB_{\max} = ค่าความหนาแน่น Flux แม่เหล็กที่เกิดขึ้นในแกนหน่วย เกาส์

A_e = พื้นที่หน้าตัดของแกนหน่วยตารางเซนติเมตร

ค่า ΔB_{\max} ทราบได้โดยใช้ตารางซึ่งการเลือกค่า ΔB_{\max} จะต้องอยู่ต่ำกว่าช่วงอิ่มตัวของแกน Ferrite ในที่นี้เลือกใช้แกน EI - 40 ที่ ΔB_{\max} เท่ากับ 1000 ค่า A_e ทราบได้จากตารางเช่นเดียวกัน

จากการคำนวณข้างต้น $N_p = 104$ รอบ

จาก $N_p = 3.433$

N_s

$$\therefore N_s = \frac{104}{3.433} = 30.29 \approx 30 \text{ รอบ}$$

5. หาค่ากระแสที่ Primary Winding

$$\text{ต้องการ } L_p \text{ ก่อน } L_p = \frac{4 \times \pi \times 1.48 \times 10^8 \times 104^2}{0.1} \\ \approx 0.2 \text{ H}$$

กำหนด $L_p \pm 20\%$

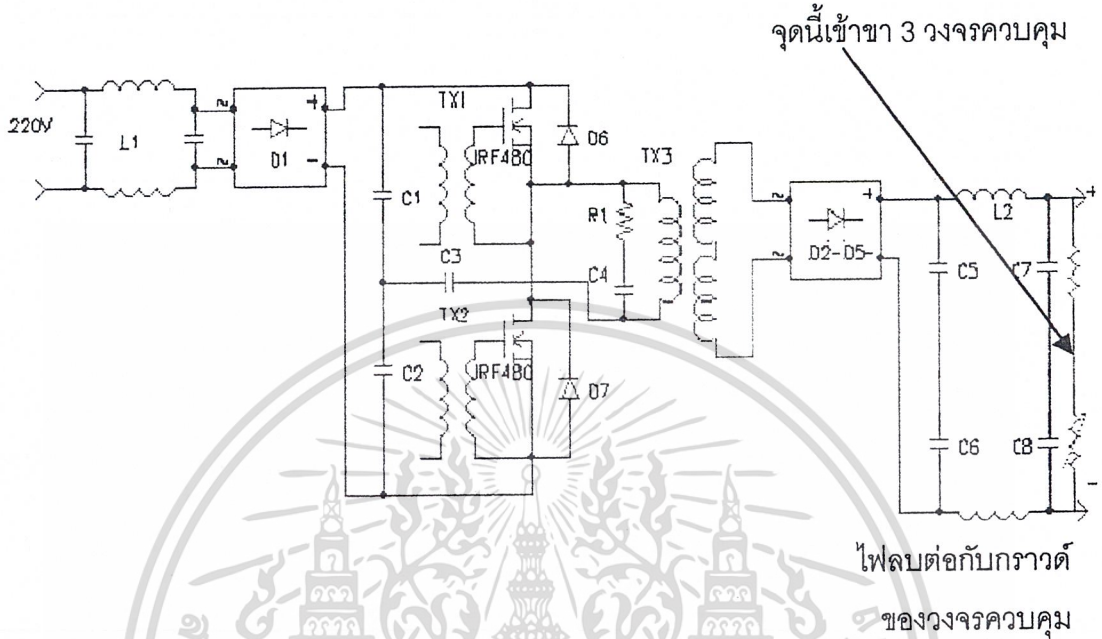
\therefore จะได้ L_p ในช่วง 0.16 – 0.24 H

$$I_{p(pk)} = \frac{100 \times 40 \times 10^{-6}}{0.8 \times 311 \times 14.2 \times 10^{-6}} + \frac{(311/2) \times 14.2 \times 10^{-6}}{0.16} \\ = 0.11 + 0.14$$

$$= 0.25 \text{ A}$$

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับบริการวิชาการเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

เมื่อได้กระแสที่ Primary แล้วทำการเลือกใช้เพาเวอร์มอสเฟต ในที่นี้ใช้มอสเฟต เบอร์ IRF 840 ซึ่งทนแรงดัน 500 โวลท์ และกระแส 5 A

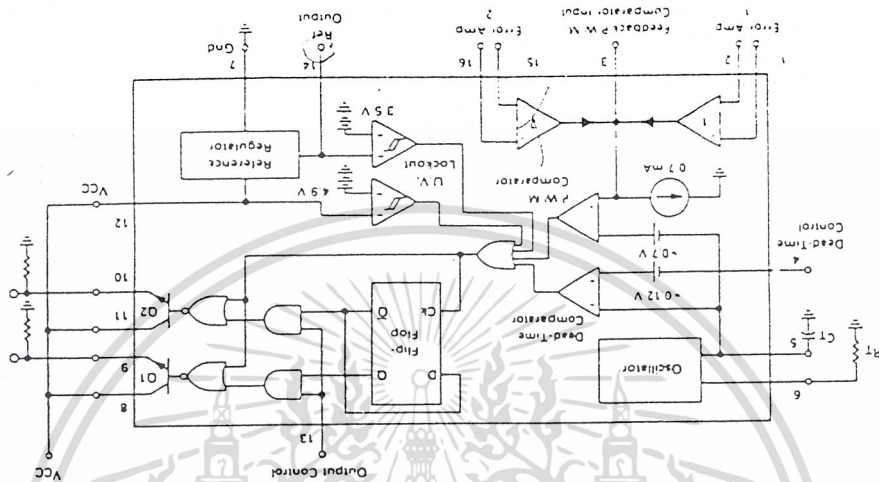


รูปที่ 1 แสดงวงจรจ่ายไฟแบบสวิตชิง

4.2 ส่วนของวงจรควบคุม

ในที่นี้ใช้ ไอซี TL 494 เป็นตัวควบคุมในโหมดแรงดัน การกำหนดความถี่สามารถกำหนดได้จาก R_T และ C_T ที่ต่ออยู่ในวงจรโดยสามารถหาค่า R_T และ C_T ที่เหมาะสมจากกราฟ ซึ่งผู้ผลิตให้มาในที่นี้เลือก C_T ที่ 200 พิโคฟารัด และ R_T เท่ากับ 20 กิโลโอห์ม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

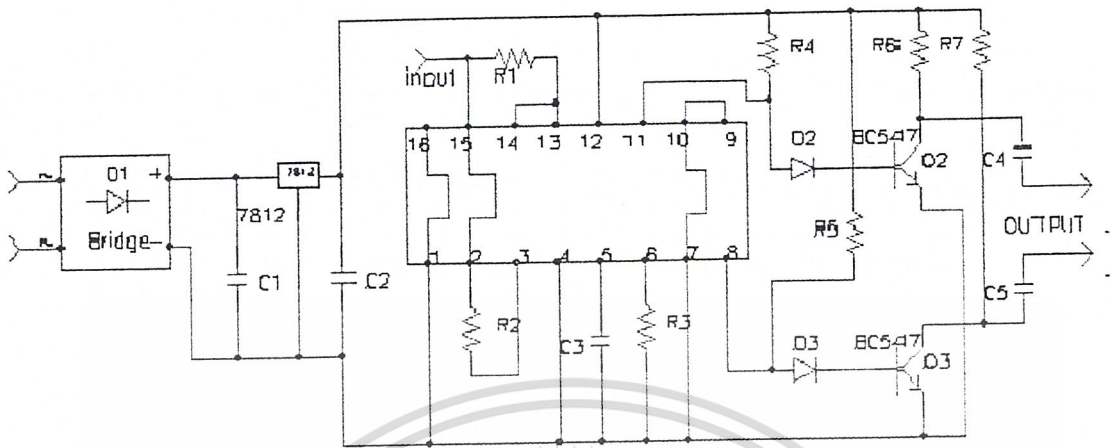


รูปที่ 2 แสดงการจัดโครงสร้างภายในและการจัดขาของไอซี TL494

เนื่องจากเอาต์พุต ของไอซีนี้เป็นแบบ Open Collector จึงต้องทำการใช้ความต้านทาน Pull Up ในที่นี้คือ R3 และ R4, Q1,Q4 ทำหน้าที่แทนไดโอด ส่วน Q2,Q3 ทำการขยาย สัญญาณให้แรงพอก่อนที่จะส่งไปยังหม้อแปลง Couple ค่าเวลาเพื่อ TD เลือกได้โดยใช้แรงดัน ต่อที่ขา 4 ในที่นี้ต่อขา 4 ลงกราวด์ ทำให้ค่าเวลาเพื่อ TD = 48 เปรอร์เซ็นต์ใช้ในกรณี Push Pull คอนเวอเตอร์กับ Half Bridge Converter หม้อแปลง T1,T2 ทำหน้าที่เป็นหม้อแปลง Coupling เพื่อต้องการให้มีการแยกกันทางไฟฟ้าระหว่างแรงดันสูงกับวงจรควบคุมแรงดันต่ำใช้ หม้อแปลงแกน Ferrite แกน EI 22 พันขด Primary 40 รอบ Secondary 40 รอบ ไม่จำเป็นต้องคำนึงเรื่องขนาดและกระแสที่ไหลเข้าขดลวดเพียงแต่ออกแบบไม่ให้หม้อแปลงอึดตัวเท่านั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานำเข้า ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า เนื่องจากเป็นหม้อแปลงที่ใช้ Coupling สัญญาณจึงไม่จำเป็นต้องใช้กำลังมาก

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



รูปที่3 แสดงวงจรควบคุม

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 5

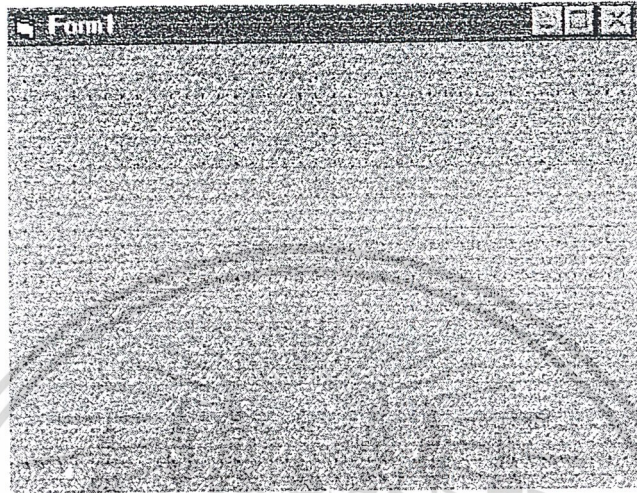
SOFTWARE

Software ในโครงการนี้เป็นโปรแกรมซึ่งใช้ในการ Simulate และช่วยในการออกแบบวงจร สวิตชิง โดยเขียนโปรแกรมขึ้นมาจาก Code ของภาษา Visual Basic 5 เหตุผลในการเลือก ใช้ภาษานี้เนื่องมาจาก Visual Basic 5 นี้เป็นโปรแกรม Compiler แบบ Object Orient Programming ซึ่งลักษณะภาษาของประเภทนี้จะสนใจเกี่ยวกับ Event หรือเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นกับ Object ต่างๆบนหน้าจออีกทั้ง Program Compiler ประเภทนี้สามารถสร้าง User Interface ได้ง่ายกว่า Compiler เดิมๆ และสามารถค้นคว้าหาข้อมูลได้ค่อนข้างง่าย ซึ่งก่อนที่จะถึงโปรแกรมจริงๆผู้จัดทำขอแนะนำส่วนประกอบที่จำเป็น คุณลักษณะและแนวทางการออกแบบไว้ในตอนต้นดังนี้

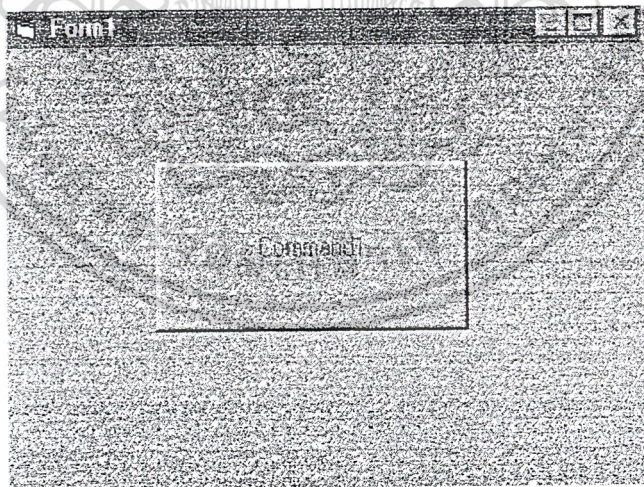
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.1 Control และ Object ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

1. Form คือส่วนฐานในการสร้างจอภาพของโปรแกรมเมื่อทำการเปิดโครงการใหม่ขึ้นมา ก็จะได้ Form เปล่าดังรูป

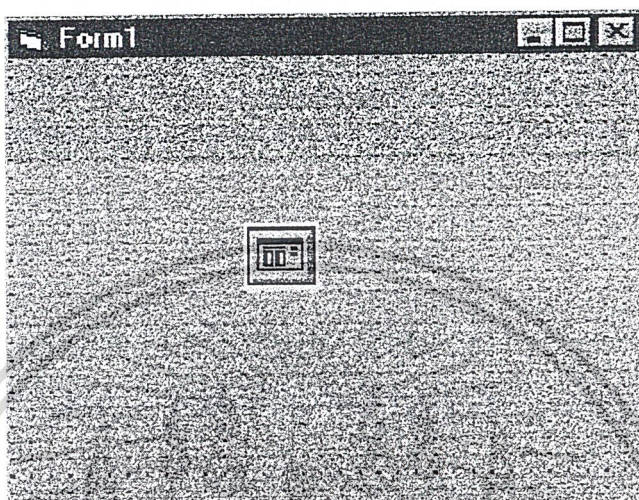


2. Command Button เป็น Control ชนิด 3 มิติ (โดยทั่วไปทำหน้าที่เป็นปุ่มกดและตอบสนองเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นกับตัว Object เอง

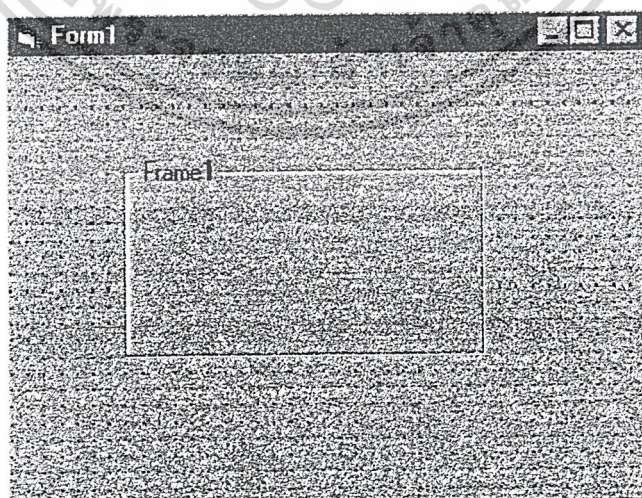


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

3.Common Dialog ทำหน้าที่เรียก Dialog Box เช่น กรณีที่ต้องการ เปิด และ เก็บ หรือ พิมพ์ เป็นต้น

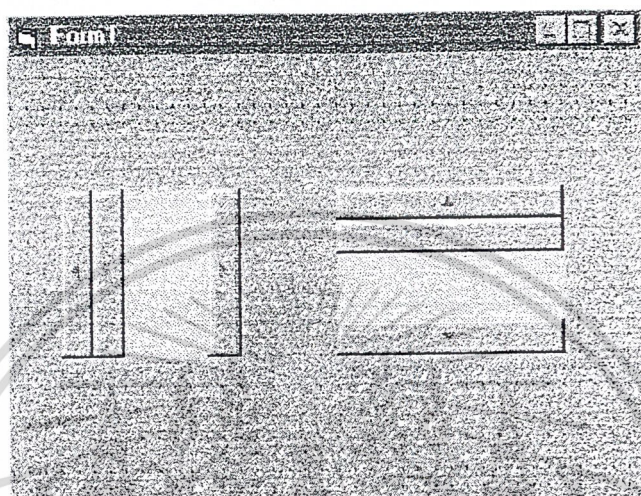


4.Frame ใช้ Frame Control ในการแบ่ง Object แต่ละชนิดให้แยกออกจากกันไป ตามชนิดนั้นๆ

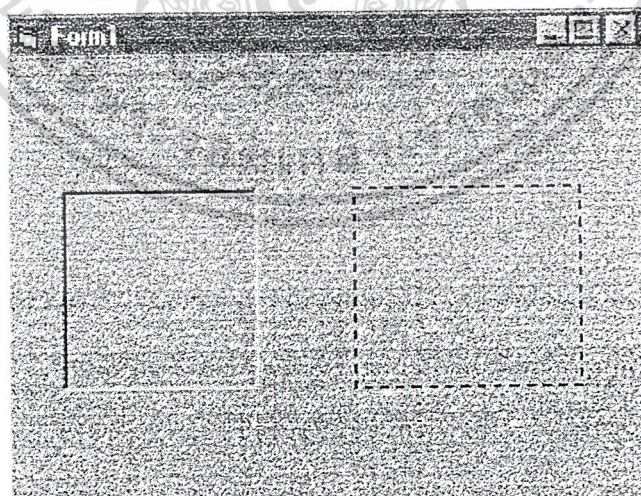


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5. Hscroll Bar , Vscroll Bar ใช้ในการปรับเลื่อนกรณีที่ใช้ Text Box เมื่อค่าที่แสดงบน Text Box มีหลายบรรทัด กรณีของ Picture Box และ Image Box เมื่อรูปที่โหลดลงไปมีขนาดใหญ่กว่าโดยที่ขณะเลื่อน Scroll Bar ไปจาก Value ของ Scroll Bar จะเปลี่ยนไปและใช้ค่า Value นี้ไปกำหนดในโปรแกรมอีกทีหนึ่ง

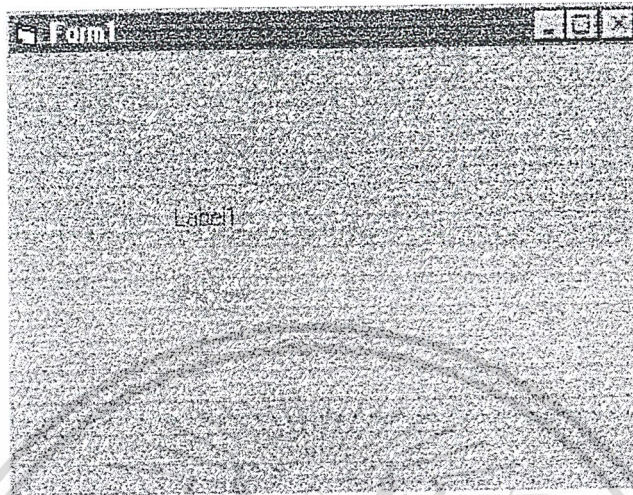


6. Image Box และ Picture Box Control ทั้งสองนี้ล้วนแต่ใช้แสดงผลทาง Graphic อื่นๆ แต่ Picture Box นั้นสามารถมีควบคุม อื่นๆ อยู่ภายในรูป ได้แต่ Picture Box มีความสามารถอื่นๆ เหนือ Image Box

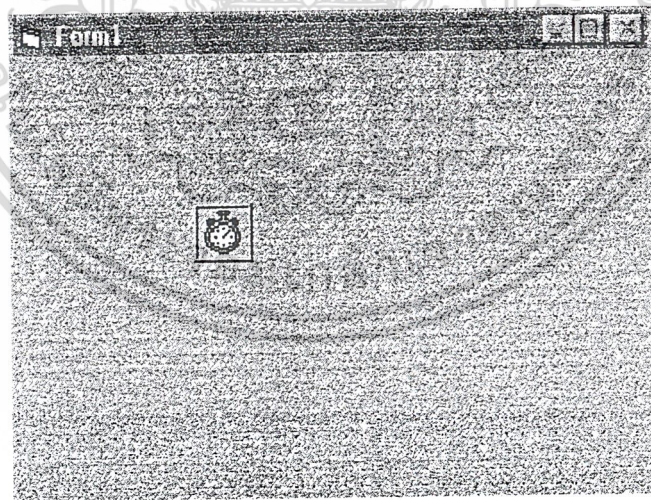


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

7. Label Control เป็น Control ที่แสดงข้อมูลใดๆที่ไม่สามารถแก้ไขได้โดยผู้ใช้โปรแกรม

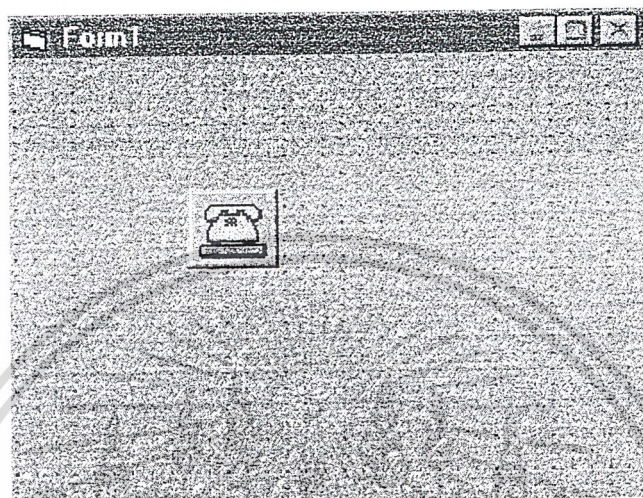


8. Timer Control เป็น Control ที่ไม่ปรากฏบนจอภาพเมื่อทำการ Run Application โดยทำหน้าที่เป็นตัวจับเวลาเพื่อกำหนดการทำงานของโปรแกรม

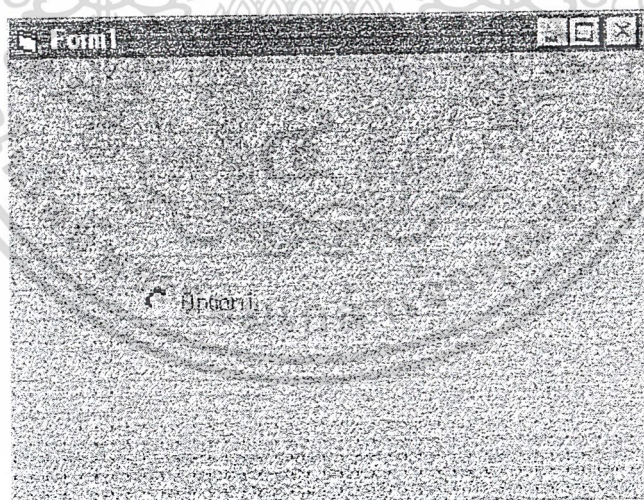


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

9. MS Comm Control ทำหน้าที่ในการกำหนดการสื่อสารกับพอร์ตโดยที่ MS Comm Control นี้เมื่อทำการรันแล้วไม่สามารถมองเห็นได้และ Control นี้จะมีเฉพาะใน Visual Basic 5 รุ่น Professional เท่านั้น

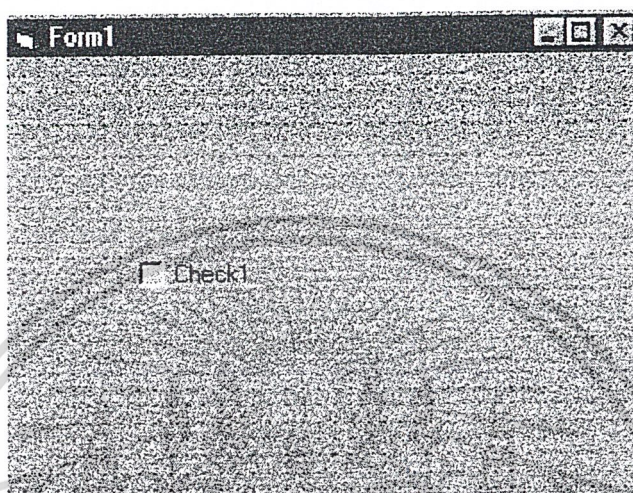


10. Option Button ทำหน้าที่ในการเลือก Choice โดยทำการเรียกได้ทีละ 1 option เท่านั้น



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

11. Check Box เป็น Control ที่ใช้ในการเลือกเงื่อนไขเช่นเดียวกับ Option Button แต่สามารถเลือกได้หลายทางเลือก



5.2 Event ที่จำเป็นในการเขียนโปรแกรม

Change เป็น Event ที่เกิดเมื่อผู้ใช้โปรแกรมทำการป้อนค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าภายใน Object นั้นๆ สำหรับ Text Box เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ใส่ค่าไปใน Text Box

HScholl Bar , VScholl Bar เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้ทำการเลื่อนแถบของ Scholl Bar ไป Click เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้โปรแกรมทำการคลิกเมาส์ ณ. Object ใดๆ ส่วนใหญ่เป็น Command Button หรือ Control ที่ใช้แสดง Graphic ในรูปของ Icon ต่างๆ เช่น Picture Box หรือ Image Box เมื่อทำการคลิกทางซ้ายค่าที่ Object จะให้มาก็จะเท่ากับ 1 ถ้าทำการคลิกทางขวา ค่าที่ Object จะให้มาก็เท่ากับ 0 ซึ่งค่าเหล่านี้สามารถเป็นตัวกำหนดเงื่อนไขในโปรแกรม ได้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

DbiClick เมื่อผู้ใช้โปรแกรมทำการ Double Click ที่ Object ใดๆก็จะเกิด Event ขึ้นมา

Got Focus เกิดขึ้นเมื่อ Object นั้นถูกคลิกให้ทำงานหรือใช้คำสั่ง Set Focus

Key Down , Key Up Event นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้โปรแกรม กด Key ที่กำหนดไว้ Event Key Down เกิดขึ้นขณะที่ผู้ใช้โปรแกรม กด Key Event Key Up เกิดขึ้นขณะที่ผู้ใช้โปรแกรมทำการปล่อย Key ที่กด ซึ่งรหัสของ Key แต่ละ Key จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 255

Key Press ลักษณะของ Event นี้คล้ายกับ Key Down ผสมกับ Key Up โดยที่ Event นี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้โปรแกรมกดปุ่มและปล่อยขึ้นมา

Load Event นี้เกิดขึ้นกับ Form เท่านั้นเกิดขึ้นขณะที่ Form ใดๆถูกเรียกขึ้นมาใช้งาน

Lost Focus เกิดขึ้นในขณะที่ Object ใดๆถูกเรียกใช้งานและเมื่อผู้ใช้งานใช้งานเสร็จแล้วใช้ปรีนเตอร์ ของเมาส์ ไปเรียกใช้ Object อื่นๆ

Mouse Down , Mouse Up Event ทั้งสองนี้เกิดขึ้นขณะที่ผู้ใช้โปรแกรมทำการกดเมาส์ ถ้ากดปุ่มซ้ายค่าที่ให้กับ Object = 1 กดปุ่มขวาที่ให้เท่ากับ 2 เมื่อทำการกดปุ่มกลางค่าที่ให้เท่ากับ 4 ส่วน Mouse Up

Mouse Move Event นี้ผู้ใช้งานโปรแกรมย้ายปรีนเตอร์ของเมาท์ขณะที่ไม่ได้ทำการกดปุ่มเมาท์อยู่ เมื่อปรีนเตอร์ชี้ไปที่จุดใดๆบน Object สามารถนำค่าพิกัดที่ปรีนเตอร์ ชี้เข้าไปใช้ในโปรแกรมได้

Paint Event เกิดเมื่อทำการย้ายหรือเปลี่ยนขนาดของ Object

Resize Event เกิดขึ้นเมื่อทำการปรับขนาดของ Form

Timer Event เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเวลาใน Object Timer

Unload Event เกิดขึ้นขณะที่ Form ถูกปิด

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.3 Method และ Property ที่ผู้ใช้เขียนโปรแกรม

Auto Redraw Property เป็น Property ที่ผู้ใช้ในการเก็บข้อมูลที่เป็น Graphic ได้ ในหน่วยความจำเมื่อทำการย่อ Form ใดๆแล้วทำการขยาย Form นั้นขึ้นมาอีกครั้งภาพ Graphic จะไม่มีอยู่เมื่อทำการรัน Program แล้วกำหนดค่า Auto Redraw = True เมื่อขยาย Form ขึ้นมาอีกครั้งภาพหน้าจอก็ยังคงอยู่

รูปแบบการใช้งาน Object Auto Redraw = Boolean Value (True Or False) , (1 และ 0) Auto Size Property เมื่อทำการไหลรูปภาพใดๆสู่ Picture Box แล้วบางครั้งรูปนั้นอาจใหญ่กว่าหรือเล็กกว่า Picture Box ที่สร้างขึ้นมากำหนดให้ Property Auto size = true แล้ว Picture Box ก็จะขยายขนาดหรือย่อขนาดให้พอดีกับรูปภาพโดยอัตโนมัติ

รูปแบบการใช้งาน Object Auto Size = (True Or False) สามารถใช้ (0 หรือ 1) แทนได้ใช้กับงาน Control 2 ชนิดคือ Picture Box และ Label ในกรณีของ Label นั้นใช้ในการกำหนดให้ Label สามารถแสดงข้อความได้หลายบรรทัด

Back Color Property เป็น Property ที่ทำการกำหนดสีพื้นของ Object ใดๆ

รูปแบบการใช้งาน Object Back Color = Long Value

Long Value = Object Back Color

ค่า Long Value ใช้กับฟังก์ชัน RGB (0-255 , 0-255, 0-255) เรียกว่าใช้จำนวนเท่าไรส่วน

Bold Property ใช้ในการกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวเข้ม (Bold) หรือไม่

รูปแบบการใช้งาน Font Bold = Boolean Value

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้... Boolean Value = Font Bold ...หน้าไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Caption Property ใช้ในการแสดงข้อความใดๆบน Object หรือ Form

รูปแบบการใช้งาน String Value = Object Caption

Object Caption = String Value

Cls Method เป็น Method ที่ใช้กับ Form และ Picture Box ใช้ในการ Clear รูปภาพหรือตัวอักษร

รูปแบบการใช้งาน Object Cls

เมื่อใช้ Method นี้แล้วค่าในตัวแปร Current X และ Current Y = 0 Current X , Current Y Property ขณะทำการรัน Graphic ค่า Current X และ Current Y จะเก็บจุดสุดท้ายที่ทำการรันนั้นๆเอาไว้ในกรณีของ Line ถ้าเป็นไซเคิลจะเก็บค่าที่เป็นจุดศูนย์กลางใช้สำหรับ Form Picture Box และปรีนเตอร์ Object

Fore Color Property ใช้ในการกำหนดสีของตัวอักษรหรือ Graphic ใดๆ ใน Object

รูปแบบการใช้งาน Long Value = Object Fore Color

Object Fore color = Long Value

Hide Method กรณีที่โครงการ มีหลายๆ Form เมื่อเราจะใช้ Form ใดๆบางครั้งต้องทำให้ Form ที่เราต้องการต้องการหายไปจากหน้าจอก็ต้องใช้ Property Hide ใช้สำหรับ Form และ MDI Form

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Index Property เมื่อเราทำการสร้าง Control Array และต้องการอ้างอิง Control
อันดับใดๆเราใช้ Index Property เป็นตัวชี้ตำแหน่ง Control นั้นๆ

รูปแบบการใช้งาน Integer Value = Object index

Left , Top Property ใช้ในการกำหนดตำแหน่งของ

Object บน Form

รูปแบบการใช้งาน Single Value = Object Left

Object Left = Single Value

Single Value = Object Top

Object Top = Single Value

Line Method ใช้ในการวาดเส้นต่างๆบน Object เช่น Form Picture Box
และปรีนเตอร์

รูปแบบการใช้งาน Object Line [Step][(X1 , Y1)]-[Step] (X2,Y2)

[Color]

Value Property เป็นตัวชี้ว่า Button ไหนถูกใช้เลือกกับ Object ประเภท Button
เช่น Option Button , Command Button

รูปแบบการใช้งาน Integer Value = Object Value

Object Value = Integer Value

Value มีค่าเท่ากับ 1 เมื่อมีการเลือก Button นั้นมีค่าเท่ากับ 0 เมื่อไม่ได้เลือก Button นั้น

เอกสารนี้เป็นเอกสารลิขสิทธิ์สงวนไว้ใช้เฉพาะในชั้นเรียนเท่านั้น มิฉะนั้นผู้ใดที่เห็นหรือได้ประโยชน์จากการคัด
ลอกโดยไม่ได้รับอนุญาตให้ถือว่าผิดกฎหมายและต้องแจ้งไปยังเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

รูปแบบการใช้งาน Object Visible = Boolean Value

Boolean Value = Object Value

ใน ปกติถ้าไม่กำหนดจะเท่ากับ 1 ซึ่งหมายความว่าสามารถมองเห็น Object นั้นๆได้ ถ้ากำหนดให้เท่ากับ 0 ก็หมายความว่า Object นั้นๆมองไม่เห็น

คำสั่งและฟังก์ชันที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม

Dim เป็นคำสั่งที่ใช้ประกาศตัวแปรว่าเป็นชนิดใด

รูปแบบ	Dim	< ชื่อตัวแปร >	As < ประกาศตัวแปร >
ประเภทตัวแปร	สัญลักษณ์	เนื้อที่ที่ใช้	ขอบเขตของค่าที่ใช้
String	\$	ความยาวของ String + 4	65535 ตัวอักษร
Integer	%	2 Byte	-32768 ถึง 32767
Long	&	4 Byte	-2147483648 ถึง 2147483647
Single	!	4 Byte	-3.402823E+38 ถึง -1.041298E+45 และ +1.401298E-45 ถึง 3.402823E+38
Double	#	8Byte	-1.797693134862315E+308 ถึง -4.9+066E-324 และ +4.94066D-324 ถึง +1.79763134862315E+308
Currency	@	8 Byte	-922337203685477.5808 ถึง +922337203685477.5807
Variant	-	Variant ตามข้อมูล	แล้วแต่จะใช้

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.4 ชนิด Operator

1. Assign Operator ใช้กำหนดค่าให้กับตัวแปรหรือ Property ให้กับ Object เช่น เครื่องหมาย "=" เป็นต้น
2. Arithmetic Operator ใช้ในการคำนวณประกอบด้วย

เครื่องหมาย	ความหมาย	ตัวอย่าง
^	ยกกำลัง	$A! = 3^4$ (3 ยกกำลัง 4)
-	เครื่องหมายลบ	$A! = -1$
*, /	คูณหรือหาร	$A! = B!$
\	หารแบบ Integer	$A\% = B\% \setminus C\%$
mod	modulo	$A\% = B\% \text{ Mod } C\%$
+, -	บวกหรือลบ	$A\% = B\% + C\%$ หรือ $A\% = B\% - C\%$
&	การต่อ String	$A\$ = B\$ \& C\$$

3. Relational Operator ใช้เปรียบเทียบประโยคคำสั่งตั้งแต่ 2 ประโยคขึ้นไปผลที่ได้มักจะเป็นจริงหรือเท็จมักใช้กับคำสั่งที่เป็นเงื่อนไข

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Operator	ความหมาย	ตัวอย่าง
=	เท่ากับ	$A\% = B\%$ เป็นจริงเมื่อค่า $A\% = B\%$
<>	ไม่เท่ากับ	$A\% <> B\%$ เป็นจริงเมื่อค่า $A\%$ ไม่เท่ากับ $B\%$
>	มากกว่า	$A\% > B\%$ เป็นจริงเมื่อค่า $A\%$ มากกว่า $B\%$
<	น้อยกว่า	$A\% < B\%$ เป็นจริงเมื่อค่า $A\%$ น้อยกว่า $B\%$
>=	มากกว่าหรือเท่ากับ	$A\% \geq B\%$ เป็นจริงเมื่อค่า $A\%$ มากกว่าหรือเท่ากับ $B\%$
<=	น้อยกว่าหรือเท่ากับ	$A\% \leq B\%$ เป็นจริงเมื่อค่า $A\%$ น้อยกว่าหรือเท่ากับ $B\%$
like	ใช้เปรียบเทียบstring	$A\$ \text{ like } B\$$ จะเป็นจริงเมื่อค่า A ตรงกับ B
is	ใช้เปรียบเทียบObject	$A \text{ is } B$ เป็นจริงเมื่อ A และ B อ้างอิงถึงObjectเดียวกัน

4. Logical Operator ใช้ในการเชื่อมประโยคหลายๆประโยคเข้าด้วยกันผลที่ได้มาจากการนำค่า True หรือ False ของแต่ละประโยคคำสั่งมาประมวลผล

Operator	สำหรับ	ตัวอย่าง
Not	Logical Negation	If Not ($A\% = B\%$)
And	Logical and	If ($A\% = B\%$) And ($C\% = D\%$)
Or	Logical Or	If ($A\% = B\%$) Or ($C\% = D\%$)
Xor	Exclusive Or	If ($A\% = B\%$) Xor ($C\% = D\%$)
Eqv	Logical Equivalent	If ($A\% = B\%$) Eqv ($C\% = D\%$)
Imp	Implication	If ($A\% = B\%$) Imp ($C\% = D\%$)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

1. กลุ่มคำสั่ง Branch ได้แก่คำสั่ง Go และ Gosub
2. กลุ่มคำสั่ง Iteration ได้แก่ Fox ___Next , Do___Loop และ While___End
3. กลุ่มคำสั่ง Condition IF___ Then ___ Else และ Select ___ Case ___ End select

บางฟังก์ชัน และบางคำสั่งในการเขียนโปรแกรม

ฟังก์ชัน Cos แสดงค่า Cos ของมุมที่กำหนด (เรเดียน)

Sin แสดงค่า Sin ของมุมที่กำหนด (เรเดียน)

Tan แสดงค่า Tan ของมุมที่กำหนด (เรเดียน)

Val แปลงค่า สตริงให้อยู่ในรูปของตัวเลข

Str แปลงค่าตัวเลขให้เป็นสตริง

Msg Box ใช้เรียก Dialog Box ที่ทำหน้าที่แสดงข้อความขึ้นมาทำงานมีรูปแบบดังนี้

Msg Box Message , [boxtype %] , [windowt ; tle %]

Input Boxเป็นการเรียกใช้ Dialog Box มาตราฐานขึ้นมาใช้ในการรับข้อมูลมีรูปแบบ

ดังนี้

Variable = Input Box \$ ("Title")

5.5 ขอบเขตของตัวแปร

ใน Visual Basic นั้นขอบเขตของตัวแปรมีอยู่ 2 ชนิดคือ Private Variable และ Public Variable ถ้าเป็น Private Variable จะเรียกใช้ได้เฉพาะ Procedure ที่ทำการประกาศตัวแปรไว้เท่านั้น ส่วน Public Variable จะทำการประกาศไว้ที่ส่วนของ General สามารถเรียกใช้ตัวแปรนี้ได้จากทุก Procedure ใน Form เดียวกันและทำการประกาศตัวแปรไว้ในส่วนของ Module แล้วจะสามารถเรียกใช้ตัวแปรนี้ได้ในทุกๆ Form ในโครงการเดียวกัน

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

5.6 การจัดการกับ File

ในการเขียนโปรแกรมกับ Visual Basic นั้นเมื่อต้องการทำการจัดการข้อมูลจะแบ่ง File ออกตามรูปแบบของการบันทึกได้เป็น 2 ชนิดคือ

1. Variable Length เป็น File ที่ขนาดของมูลแต่ละบล็อก แต่ละบันทึกไม่ตายตัว
 - 1.1. Sequential File การเข้าถึงข้อมูลกระทำทีละไบต์ จากต้น File จนกระทั่งสิ้นสุด File
 - 1.2. Binary File การเข้าถึงข้อมูลจะเข้าถึงทีละบิท

2. Fixed Length เป็น File ที่ข้อมูลแต่ละบล็อก หรือ บันทึกตายตัวเท่ากันทุกรายการ เพราะฉะนั้นแต่ละไบต์ จึงให้ความหมายต่างกัน

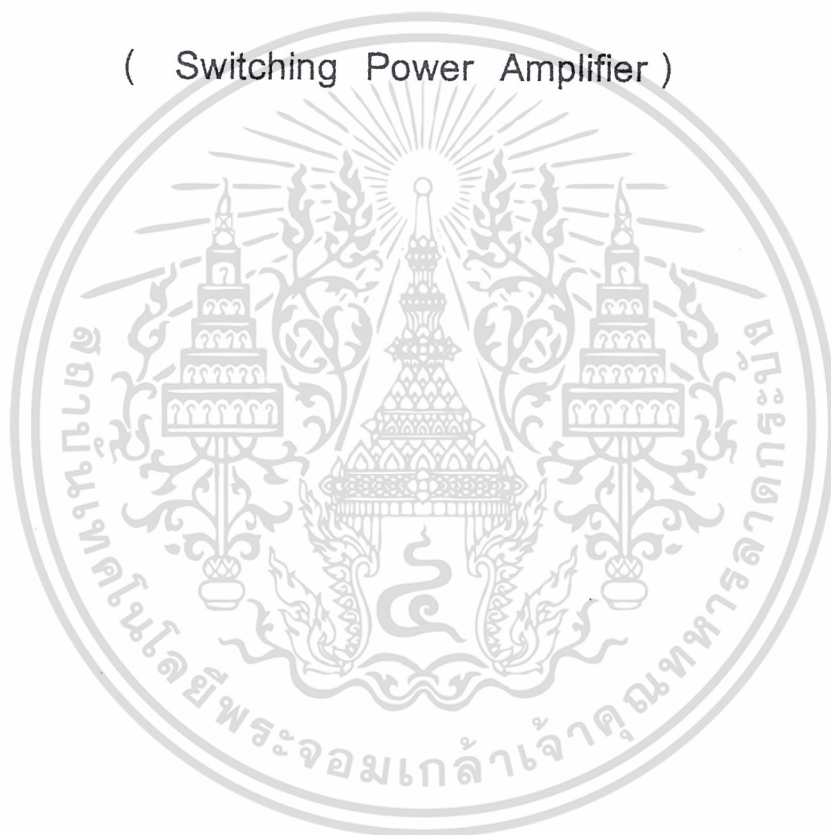
2.1. Random Access File สามารถกำหนดหมายเลขบันทึกที่ต้องการได้โดยไม่ต้องเริ่มจากต้น File (ในโปรเจกต์นี้ได้ใช้ Random Access File ในการเขียนโปรแกรม)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

บทที่ 6

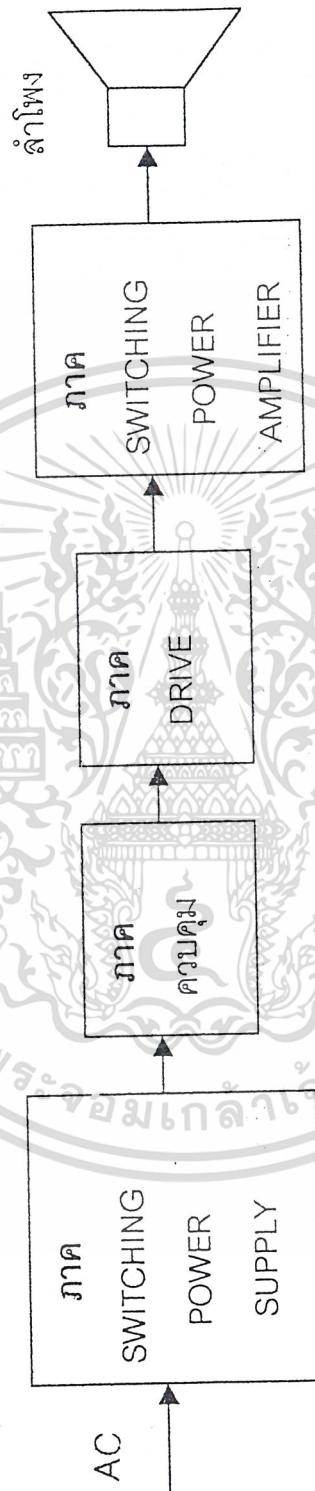
ชิ้นงานเครื่องขยายกำลังแบบสวิตชิง

(Switching Power Amplifier)

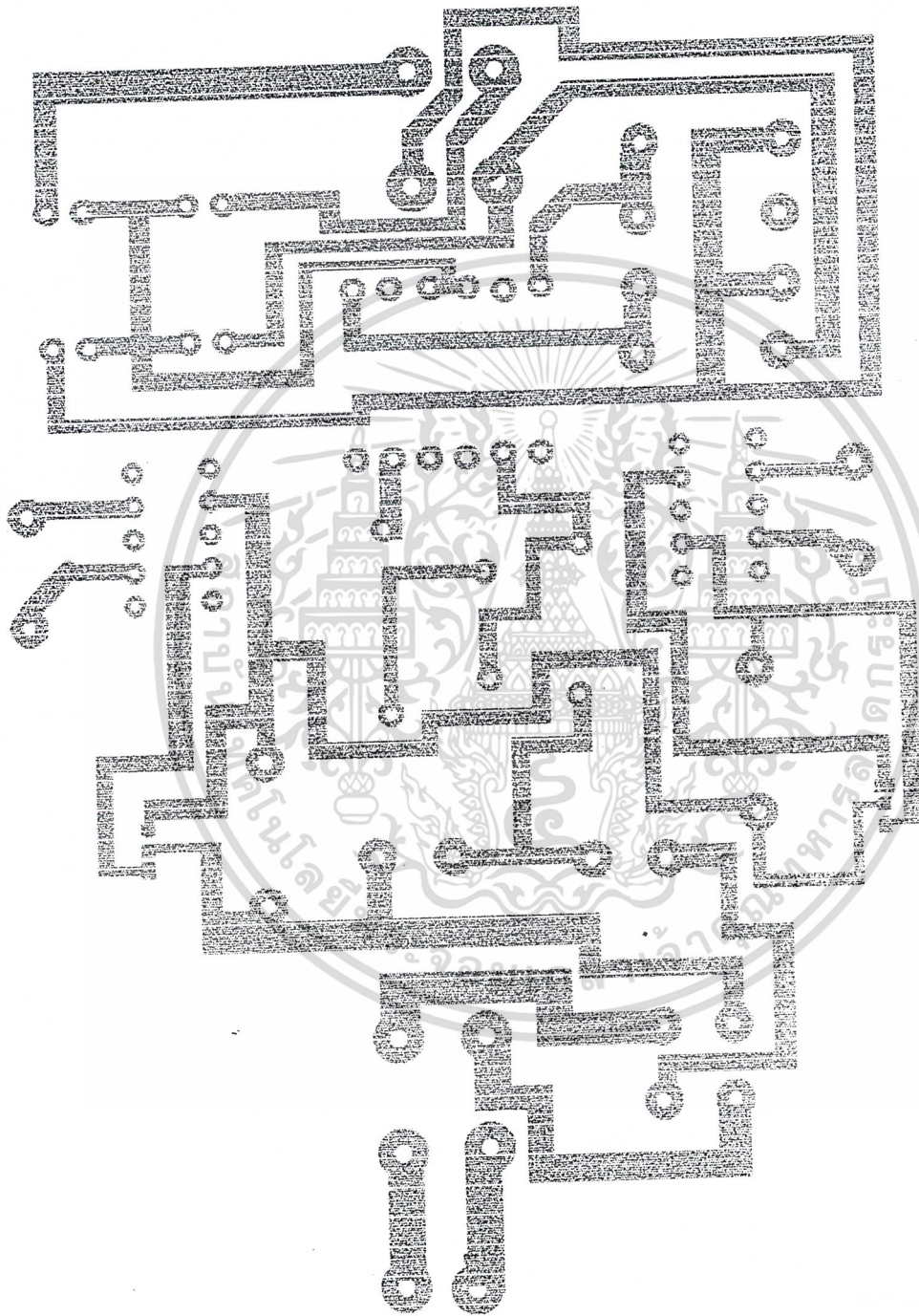


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.1 Block Diagram

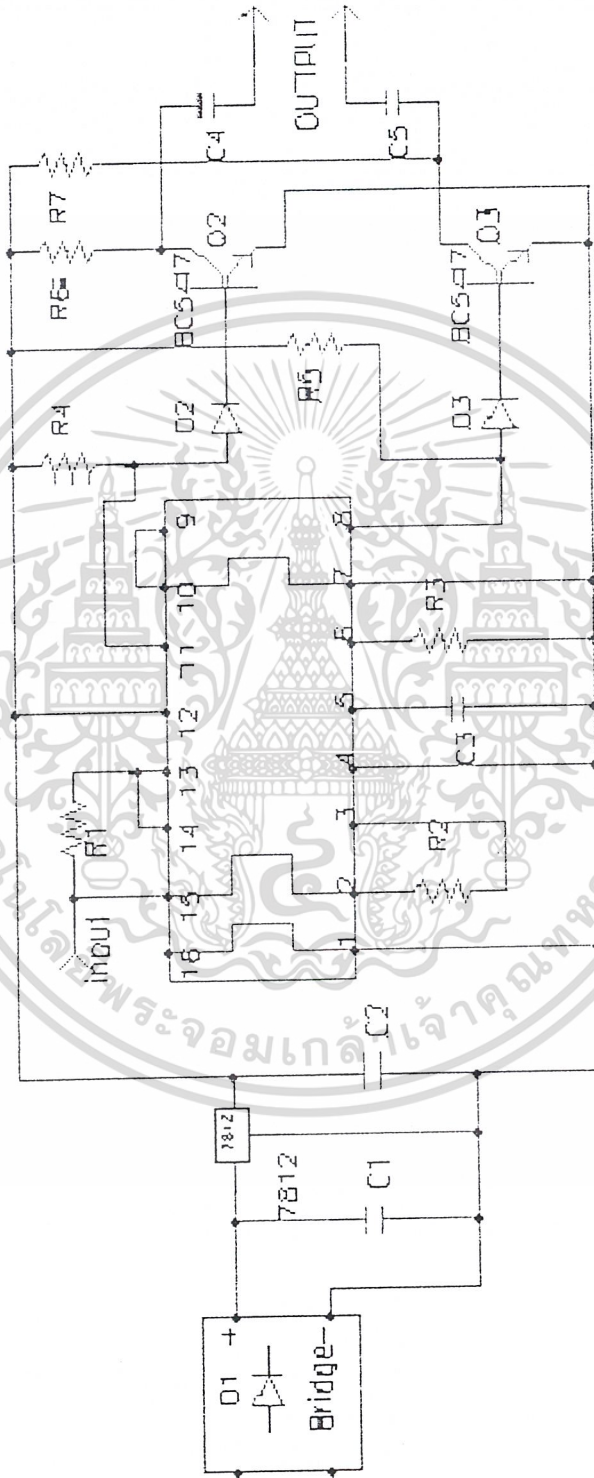
BLOCK DIAGRAM

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

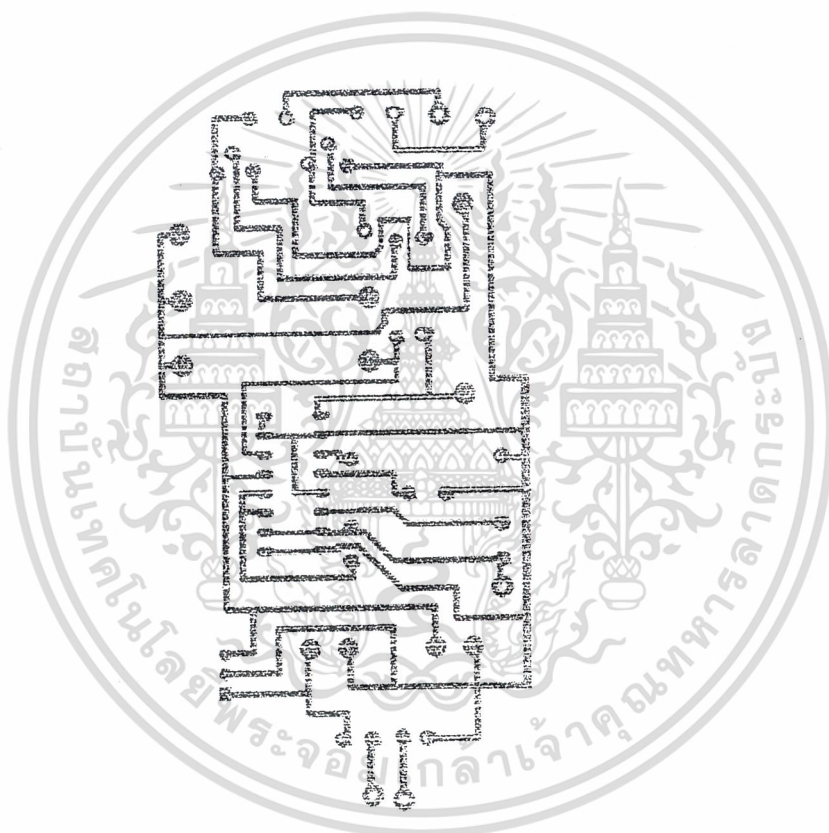


เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

วงจรควบคุม



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6.3 การทดลองและแสดงผล

```
Const pi = 3.141592654
```

```
Option Explicit
```

```
Private Sub Cmd_clear_Click()
```

```
Picture1.Cls
```

```
Cmd_clear.Enabled = False
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Cmd_O_Click()
```

```
Dim chk_o As pnt
```

```
Open "c:\switching.txt" For Random As #1 Len = Len(chk_o)
```

```
If Text1.Text = "" Then
```

```
Text1.Text = "1"
```

```
End If
```

```
If Val(Text1.Text) >= 0 Then
```

```
Data_appear (Text1)
```

```
End If
```

```
Close #1
```

```
Cmd_save.Enabled = True
```

```
Cmd_O.Visible = False
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Cmd_open_Click()
```

```
Cmd_save.Enabled = 0
```

```
Cmd_ok.Visible = False
```

```
Cmd_O.Visible = True
```

```
Object
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Cmd_S_Click()
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

.Sine_Freq = Text3.Text
.Saw_amp = Text4.Text
.Saw_freq = Text5.Text
.Crlf = Chr(13) & Chr(10)

End With

If Text1.Text = "" Or Val(Text1.Text) < 0 Then
    Text1.Text = "1"
End If

Put #1, Val(Text1.Text), Chk_S

Close #1
Cmd_open.Enabled = True
Cmd_S.Visible = False

End Sub

Private Sub cmd_save_Click()
    Cmd_S.Visible = True
    Cmd_O.Visible = False
    Cmd_open.Enabled = False
Object
End Sub

Private Sub Cmd_sim_Click()
    Cmd_ok.Visible = 1
    Label2.Visible = 0
    Label3.Visible = 1
    Label4.Visible = 1
    Label5.Visible = 1
    Label6.Visible = 1
    Text1.Visible = 0
    Text2.Visible = 1
    Text3.Visible = 1
    Text4.Visible = 1
    Text5.Visible = 1
    Label3.Caption = "แรงดันของข้อมูล(Volt)"

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้ภายในเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้คัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลข้างต้นไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

```
Label4.Caption = "ความถี่ของข้อมูล(Hz)"
```

```
Label5.Caption = "แรงดันของ Sawtooth(Volt)"
```

```
Label6.Caption = "ความถี่ของ Sawtooth(Hz)"
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Cmd_ok_Click()
```

```
    If Val(Text3.Text) < 0 Or Val(Text5.Text) < 0 Then
```

```
        MsgBox "ค่าของความถี่เป็นบวกเท่านั้น", vbInformation + vbOKOnly, _  
            "ข้อมูลผิดพลาด"
```

```
    End If
```

```
    With Picture1
```

```
        .ScaleHeight = 7656
```

```
        .ScaleLeft = 0
```

```
        .ScaleTop = 0
```

```
        .ScaleWidth = 9192
```

```
        .Visible = True
```

```
    End With
```

```
    Cmd_open.Enabled = True
```

```
    Cmd_save.Enabled = True
```

```
    If Val(Text3.Text) >= 0 And Val(Text5.Text) >= 0 Then
```

```
        Call Simm_1(100 * (Val(Text2.Text)), (Val(Text3.Text) / 500), _
```

```
            (Val(Text4.Text) * 100), (Val(Text5.Text) / 500)
```

```
    End If
```

```
    Close #1
```

```
End Sub
```

```
Private Sub Form_Load()
```

```
    Dim count As Integer
```

```
    For count = 0 To 12
```

```
        Label1(count).Visible = False
```

```
    Next count
```

```
    Cmd_S.Visible = False
```

```
    Cmd_O.Visible = False
```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมีเหตุใดที่แปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

```

Cmd_clear.Enabled = False
Label2.Visible = False
Label3.Visible = False
Label4.Visible = False
Label5.Visible = False
Label6.Visible = False
Text1.Visible = False
Text2.Visible = False
Text3.Visible = False
Text4.Visible = False
Text5.Visible = False
Cmd_ok.Visible = False
End Sub

Private Sub Picture1_GotFocus()
Picture1.AutoRedraw = 0
End Sub

Public Sub Simm_1(Vsin, Tsin, Vsaw, Tsaw As Single)
Dim Xpos, Ypos, count As Integer
Dim Xsaw, Ysaw, Xsin, Ysin, Xpwm, ratio, a, b, c As Single
Dim ceta, phi As Double

'----- Scale Plotting -----

Picture1.DrawWidth = 1

For count = 0 To 44

Picture1.Line (0, Ypos)-(9520, Ypos), QBColor(1)

Ypos = Ypos + 170

Next count

For count = 0 To 55

Picture1.Line (Xpos, 0)-(Xpos, 7650), QBColor(1)
Xpos = Xpos + 170

Next count

'----- Sin Plotting -----

Picture1.DrawWidth = 2

```

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่งข้าพเจ้าขอแจ้งถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

a = 1

Picture1.CurrentX = 0

Picture1.CurrentY = 1700

b = 50

c = 200

For count = 0 To 4000

If (count / b) = c Then

a = a * Rnd

b = b * 2

End If

Ysin = 1700 - (Vsin * Sin(a * ceta))

Picture1.Line (Picture1.CurrentX, Picture1.CurrentY)-

(Xsin, Ysin), QBColor(10)

Xsin = Xsin + Tsin

ceta = ceta + 0.0314159265

Next count

----- Sawtooth Plotting -----

Picture1.CurrentX = 0

Picture1.CurrentY = 1700

For count = 0 To 4000

Ysaw = 1700 - (((Val(Vsaw)) * Cos(phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 9)) * Cos(3 * phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 25)) * Cos(5 * phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 49)) * Cos(7 * phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 81)) * Cos(9 * phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 121)) * Cos(11 * phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 169)) * Cos(13 * phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 225)) * Cos(15 * phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 289)) * Cos(17 * phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 361)) * Cos(19 * phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 441)) * Cos(21 * phi)) +

(((Vsaw * 2) / (pi * 529)) * Cos(23 * phi)))

Picture1.Line (Picture1.CurrentX, Picture1.CurrentY)-

(Xsaw, Ysaw), QBColor(14)

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับใช้ในการวิจัยทางวิชาการเท่านั้น ไม่ควรนำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้เผยแพร่ข้อมูลหรืองานวิจัยนี้แก่สาธารณชนทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

$$X_{saw} = X_{saw} + T_{saw}$$

$$\phi = \phi + 0.0314159265$$

Next count

----- PWM Plotting -----

If $T_{sin} > 0$ And $T_{saw} > 0$ Then

$$\text{ratio} = T_{sin} / T_{saw}$$

End If

If $T_{sin} = 0$ Or $T_{saw} = 0$ Then

$$\text{ratio} = 1$$

End If

$$\text{count} = 0$$

$$\text{ceta} = 0$$

$$\phi = 0$$

$$\text{Picture1.CurrentX} = 0$$

$$\text{Picture1.CurrentY} = 500$$

$$Y_{saw} = 0$$

$$Y_{sin} = 0$$

For count = 0 To 4000

$$Y_{saw} = (V_{saw} * \cos(\text{ratio} * \phi)) + \frac{((V_{saw}^2) / (9 * \pi)) * \cos(3 * \text{ratio} * \phi)}{2} + \frac{((V_{saw}^2) / (25 * \pi)) * \cos(5 * \text{ratio} * \phi)}{2} + \frac{((V_{saw}^2) / (25 * \pi)) * \cos(7 * \text{ratio} * \phi)}{2} + \frac{((V_{saw}^2) / (81 * \pi)) * \cos(9 * \text{ratio} * \phi)}{2} + \frac{((V_{saw}^2) / (121 * \pi)) * \cos(11 * \text{ratio} * \phi)}{2} + \frac{((V_{saw}^2) / (169 * \pi)) * \cos(13 * \text{ratio} * \phi)}{2}$$

$$Y_{sin} = V_{sin} * \sin(\text{ceta})$$

$$\text{ceta} = \text{ceta} + 0.0314159265$$

$$\phi = \phi + 0.0314159265$$

If $Y_{sin} > Y_{saw}$ Then

Picture1.Line (Picture1.CurrentX, 4000)-(Xpwm, 4000) _
 , QBColor(12)

End If

If $Y_{sin} < Y_{saw}$ Then

Picture1.Line (Picture1.CurrentX, 5500)-(Xpwm, 5500) _

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
 ไม่ว่าจะกรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามเผยแพร่แบบสงวนเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

, QBColor(12)

End If

Xpwm = Xpwm + Val(Tsin)

Next count

Cmd_clear.Enabled = True

End Sub

Public Sub Object()

Cmd_ok.Visible = 1

Label2.Visible = 1

Label3.Visible = 1

Label4.Visible = 1

Label5.Visible = 1

Label6.Visible = 1

Text1.Visible = 1

Text2.Visible = 1

Text3.Visible = 1

Text4.Visible = 1

Text5.Visible = 1

Label2.Caption = "ค่าค้ำของข้อมูล"

Label3.Caption = "แรงค้ำของข้อมูล"

Label4.Caption = "ความถี่ของข้อมูล"

Label5.Caption = "แรงค้ำของ Sawtooth"

Label6.Caption = "ความถี่ของ Sawtooth"

End Sub

Public Sub Data_appear(inum As Integer)

Dim chk_o As pnt

Get #1, inum, chk_o

Text2.Text = chk_o.Sine_Amp

Text3.Text = chk_o.Sine_Freq

Text4.Text = chk_o.Saw_amp

Text5.Text = chk_o.Saw_freq

End Sub

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ตัดแปะสิ่งนี้ไปเผยแพร่ในที่สาธารณะของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

tion Explicit

Type pnt

Sine_Amp As String * 2

Sine_Freq As String * 4

Saw_amp As String * 3

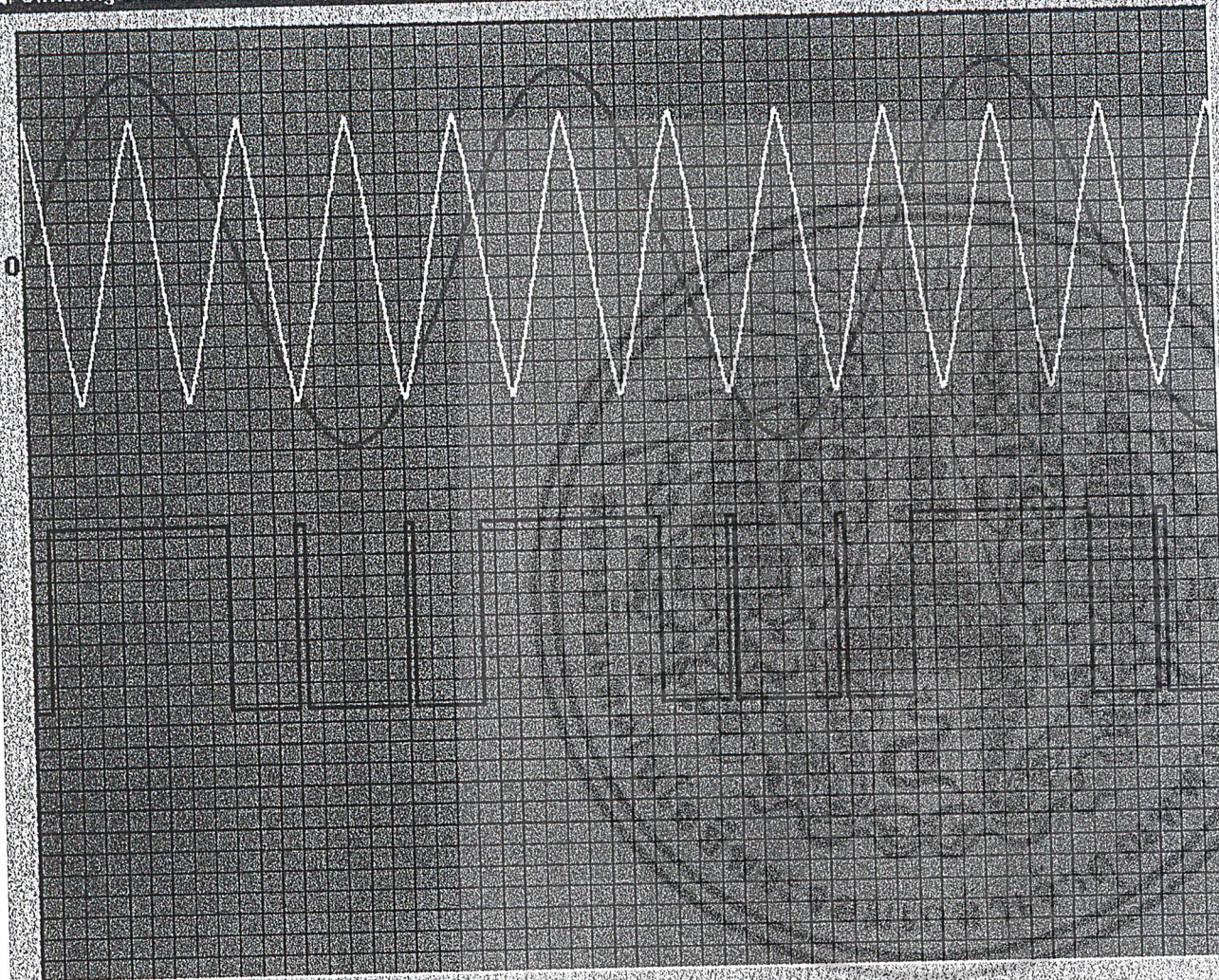
Saw_freq As String * 4

Crlf As String * 2

End Type



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้



แรงดันของซายนูส(Volt)

15

ความถี่ของซายนูส(Hz)

1500

แรงดันของ Sawtooth(Volt)

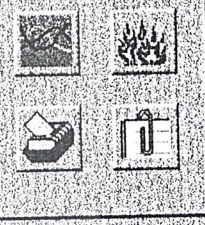
10

ความถี่ของ Sawtooth(Hz)

6000

จำลอง

Function



6.4 สรุปผลและวิจารณ์

สรุปผลและวิจารณ์

วงจรขยายกำลังแบบคลาสดี เป็นวงจรขยายสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากมีการใช้สัญญาณ Pulse width modulator มาควบคุมการสวิตช์ของเพาเวอร์มอสเฟตให้มีการเปิด และปิด โดยในช่วงที่มอสเฟต on เกือบจะไม่มีโวลเตจตกคร่อมมอสเฟตเลย และในช่วงที่มอสเฟต off เกือบจะไม่มีกระแสไหลผ่านมอสเฟตเลย ดังนั้นการสูญเสียพลังงานในรูปความร้อนที่ตัวมอสเฟตจึงมีน้อยมาก

ข้อเสียของวงจร คือ ความเพี้ยนของสัญญาณเอาต์พุตจะมีมาก เนื่องจากวงจรนี้ต้องนำเอาสัญญาณสามเหลี่ยมมาทำการมอดูเลตสัญญาณอินพุต จึงจำเป็นต้องออกแบบวงจรของความถี่ต่ำที่ดีมากๆ เพื่อที่จะกรองสัญญาณสามเหลี่ยมออกมาให้หมด ให้เหลือแต่สัญญาณอินพุต

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้าไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

หนังสืออ้างอิง

1. Hirotaka Koizumit , Minoru Iwadaret , Shinsaku Morit and Kazunage Ikeda , “ A class D type High Frequency Tuned Power Amplifier with class E switching conditions ” , TEEE Power electronic conf. ,pp 105 – 107 , Dec 1994
2. Ronaldo C. Oliveira , Ernane A. A. JoaoB. Viera Jr. Luize. Freitas and Valteir J Farias , “ Switching Power Amplifier with soft commutation for Audio Application , “ IEEE Powerelectronic conf. , pp 557 – 560 , Nov 1995
3. สุวัฒน์ ดันข ” สวิตชิงเพาเวอร์ซัพพลาย , “ บริษัทเอนเทลไทย , พิมพ์ครั้งที่ 2 , มิถุนายน 2538
4. Harold Davis , “ Visual Basic 5 Secrets “ , IDG books , 1997
5. Vincent Chen , John Montgomery , woody Leon hard , “ Hack Guide to Visual Basic “ , Addison – Wesley publishing , 1996

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

ภาคผนวก

เครื่องขยายกำลังแบบสวิทชิง



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

HIGH SLEW RATE OP AMP

SE/NE538

DESCRIPTION

The SE/NE538 is a new generation operational amplifier featuring high slew rates combined with improved input characteristics. Internally compensated for gains of 5 or larger, the SE538 offers guaranteed minimum slew rates of 40V/μs or larger. Featuring 2mV max input offset voltage, the 538 is a single amplifier. Industry standard pin out and internal compensation allow the user to upgrade system performance by directly replacing general purpose amplifiers, such as 748, 101A and 741.

FEATURES

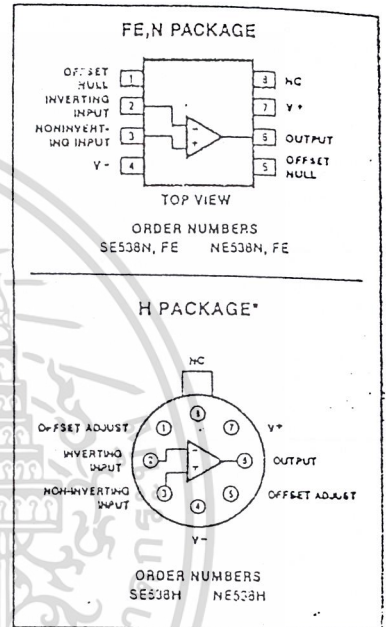
- 2mV Input offset voltage
- 80nA max input offset current
- Short circuit protected
- Offset null capability
- Large common mode and differential voltage ranges
- 60V/μs slew rate (gain of +5, -4 min)
- 6MHz gain bandwidth product (gain +5, -4 minimum)
- Internal frequency compensation (gain of +5, -4 minimum)
- Pin out: 538 same as 741 (single)

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS^{1,2,3}

PARAMETER	RATING	UNIT
V _{cc} Supply voltage		
SE military grade	±22	V
NE commercial grade	±18	V
P _D Internal power dissipation	1000	mW
FE package ¹		
N package	500	mW
P _D Internal power dissipation ¹		
H package	800	mW
Differential Input voltage	±30	V
Input voltage ²	±15	V
Operating temperature range		
SE military grade	-55 to +125	°C
NE commercial grade	0 to 70	°C
Output short circuit ³	indefinite	
Storage temperature range	-65 to +150	°C
Lead temperature (solder, 60sec.)	300	°C

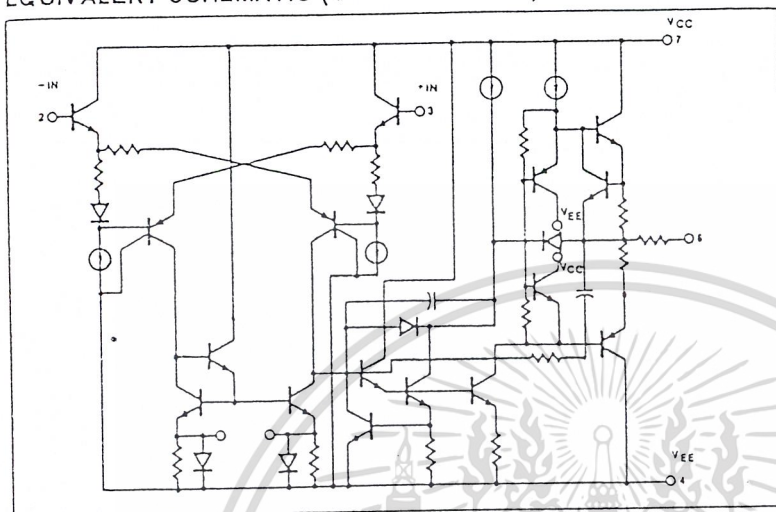
NOTES

1. Rating applies for thermal resistances of 240°C/W and 150°C/W junction to ambient for N and H packages. Maximum chip temperature is 150°C.
2. For supply voltages less than ±15V, the absolute maximum input voltage is equal to the supply voltage.
3. Short circuit may be to ground or either supply. Rating applies to 125°C case temperature or 75°C ambient temperature.



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

EQUIVALENT SCHEMATIC (EACH AMPLIFIER)



DC ELECTRICAL CHARACTERISTICS $T_A = 25^\circ\text{C}$, $V_S = \pm 15\text{V}$ unless otherwise specified.

PARAMETER	TEST CONDITIONS	SE538			NE538			UNIT
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
V_{OS} Input offset voltage	$R_S \leq 10\text{k}\Omega$ $R_S \leq 10\text{k}\Omega$, over temp.		0.7	4.0	2.0	6.0	mV	
ΔV_{OS} Input offset voltage drift	$R_S = 0\Omega$, over temp.		4.0		6.0		$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$	
I_{OS} Input offset current	Over temp.		5	20	15	40	nA	
ΔI_{OS} Input offset current	Over temp.		25	40	40	80	$\text{pA}/^\circ\text{C}$	
I_B Input current	Over temp.		45	80	65	150	nA	
ΔI_B Input current	Over temp.		50	200	80	200	$\text{pA}/^\circ\text{C}$	
V_{CM} Input common mode voltage range		≈ 12	≈ 13		≈ 12	≈ 13	V	
CMRR Common mode rejection ratio	$R_S \leq 10\text{k}\Omega$, over temp.	70	90		70	90	dB	
PSRR Power supply rejection	$R_S \leq 10\text{k}\Omega$, over temp.		30	150	30	150	$\mu\text{V}/\text{V}$	
R_{IN} Input resistance		3	10		1	6	M Ω	
A_{VOL} Large signal voltage gain	$R_L \geq 2\text{k}\Omega$, $V_{OUT} = \pm 10\text{V}$ Over temp., $R_L \geq 2\text{k}\Omega$, $V_{OUT} = \pm 10\text{V}$	50	200		50	200	V/mV	
V_{OUT} Output voltage	Over temp., $R_L \geq 2\text{k}\Omega$ Over temp., $R_L \geq 10\text{k}\Omega$	≈ 10 ≈ 12	≈ 13 ≈ 14		≈ 10 ≈ 12	≈ 13 ≈ 14	V	
I_{CC} Supply current	Per amplifier Over temp., per amplifier		2 2.2	3 3.6		2 2.2	3 3.6	mA
P_D Power dissipation	Per amplifier Over temp., per amplifier		60 66	90 108		60 66	90 108	mW
I_{SC} Output short circuit current		10	25	50	10	25	50	mA
R_{OUT} Output resistance			100			100	Ω	

NOTE

Temperature Range
SE Types $-55^\circ\text{C} \leq T_A \leq 125^\circ\text{C}$
NE Types $0^\circ\text{C} \leq T_A \leq 70^\circ\text{C}$

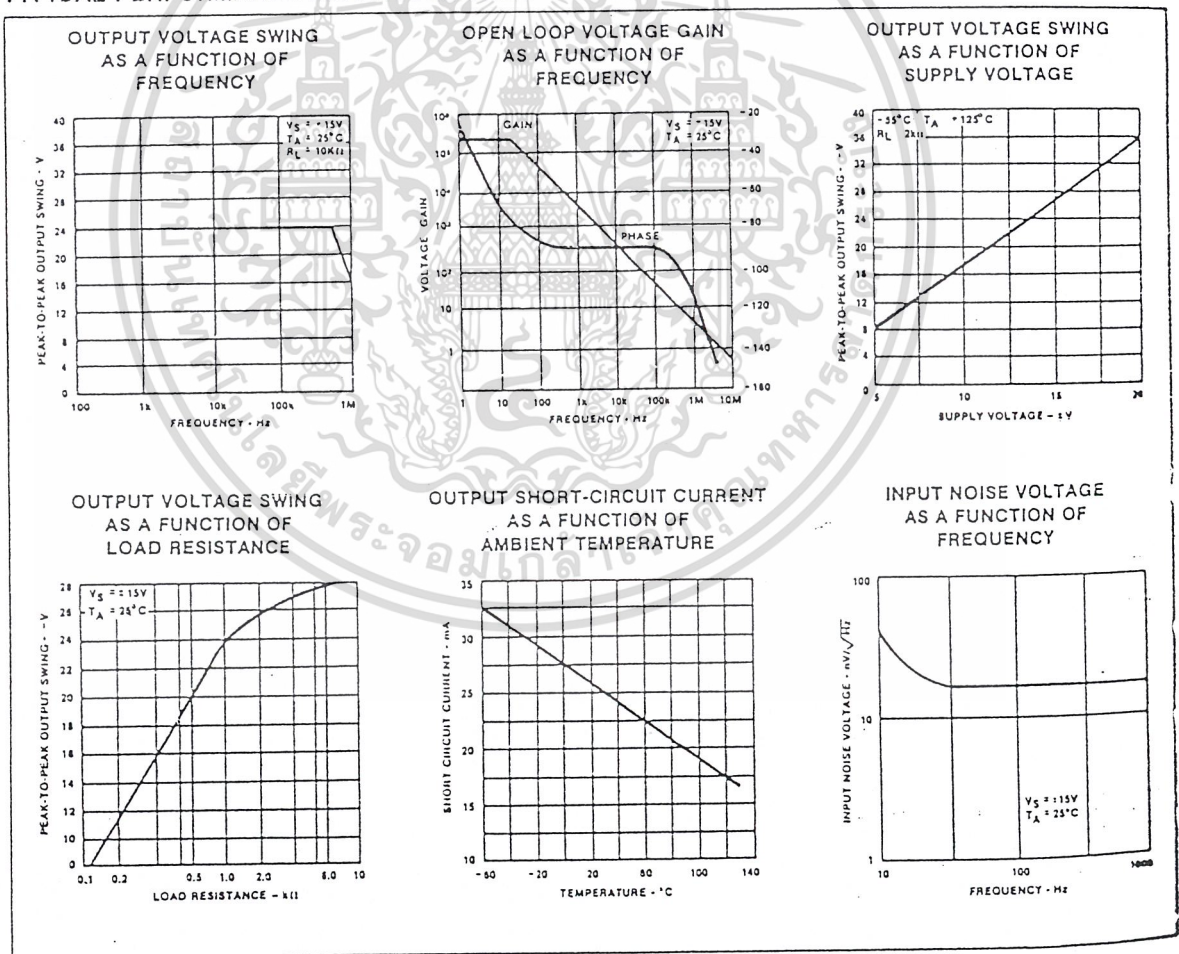
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

6

AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified.

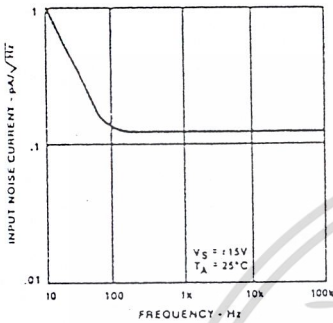
PARAMETER	TEST CONDITIONS	SE538/SE5538			SE538/NE5538			UNIT
		Min	Typ	Max	Min	Typ	Max	
Gain bandwidth product (Gain +5, -4 minimum)			6			6		MHz
Transient response Small signal rise time Small signal overshoot			0.25 6			0.25 6		μs %
Settling time	To 0.1%		1.2			1.2		μs
Slew rate	Minimum gain = 5 Noninverting $R_L \geq 2\text{k}\Omega$	40	60			60		$\text{V}/\mu\text{s}$
Input noise voltage	$f = 1\text{kHz}, T_A = 25^\circ\text{C}$		30			30		$\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$

TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS

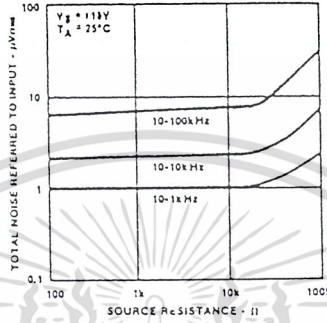


TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Cont'd)

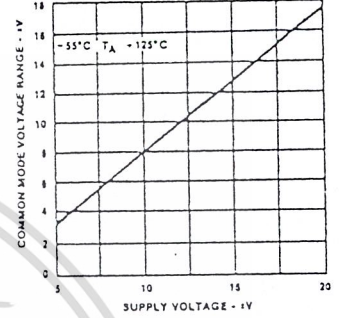
INPUT NOISE CURRENT AS A FUNCTION OF FREQUENCY



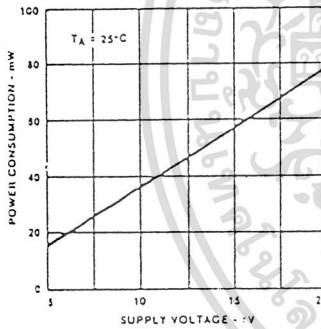
BROADBAND NOISE FOR VARIOUS BANDWIDTHS



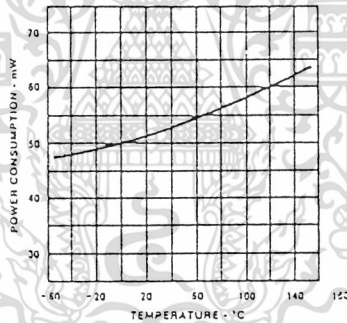
INPUT COMMON MODE VOLTAGE RANGE AS A FUNCTION OF SUPPLY VOLTAGE



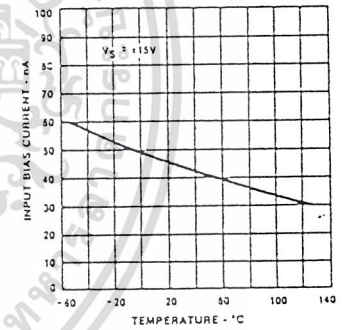
POWER CONSUMPTION AS A FUNCTION OF SUPPLY VOLTAGE



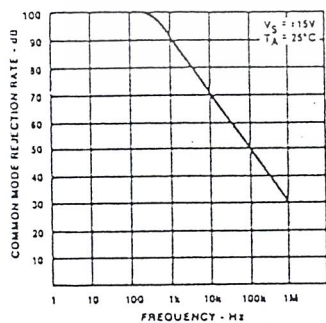
POWER CONSUMPTION AS A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE



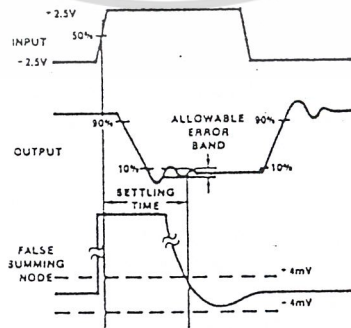
INPUT BIAS CURRENT AS A FUNCTION OF AMBIENT TEMPERATURE



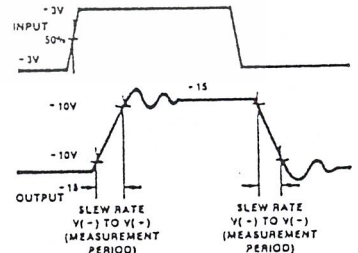
COMMON MODE REJECTION RATIO AS A FUNCTION OF FREQUENCY



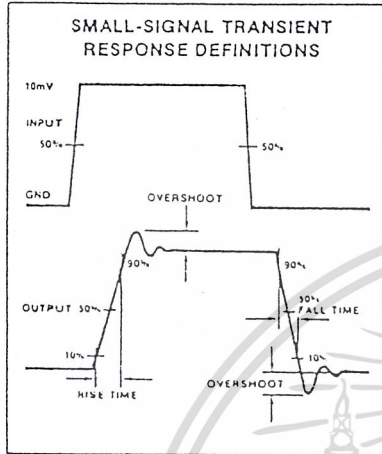
SETTLING TIME MEASUREMENT WAVEFORMS



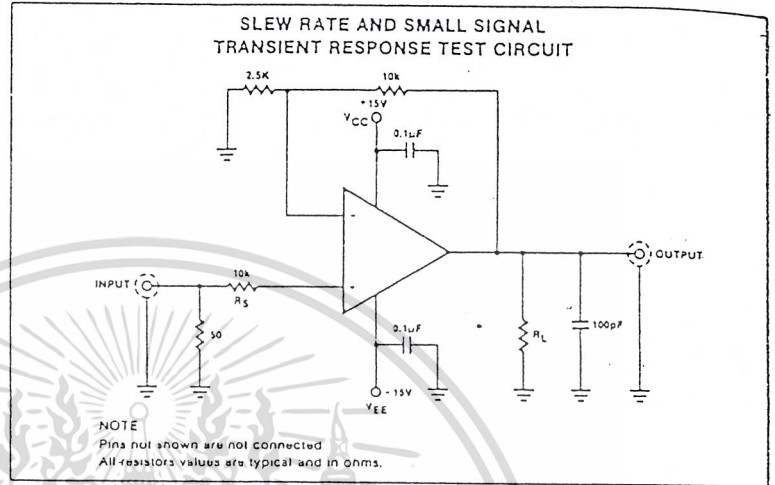
SLEW RATE MEASUREMENT V_{CC} = ±20V



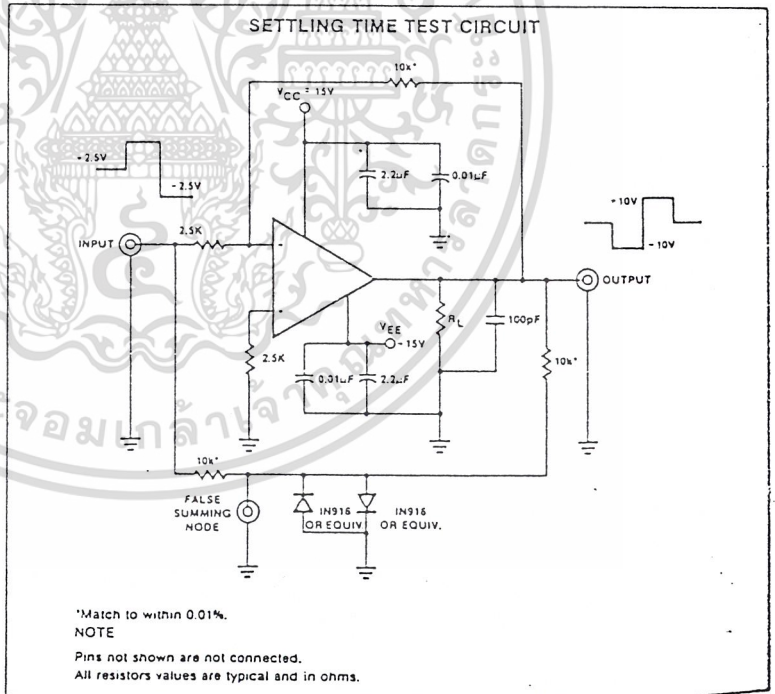
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS (Cont'd)



TEST LOAD CIRCUITS



TEST LOAD CIRCUITS (Cont'd)



INTRODUCTION

The Signetics NE538 is an undercompensated op amp. The NE538 has a typical slew rate of 50V/μs and a gain bandwidth product of 6MHz.

The internal frequency compensation is designed for a minimum inverting gain of 4 and a minimum non-inverting gain of 5. Below these gains the NE538 will be unstable and will need external compensation (see Figure 1 and 2).

The higher slew rate of the NE538 has made this device quite appealing for high speed designs and the fact that it has a standard pinout will allow it to be used to upgrade existing systems that now use the μA741 or μ748.

Equations:

$$f_{LAG} = \frac{1 (6\text{MHz})}{10} = \frac{1}{2\pi R_L C_L}$$

$$f_{LEAD} = 6\text{MHz} = \frac{1}{2\pi R_F C_F}$$

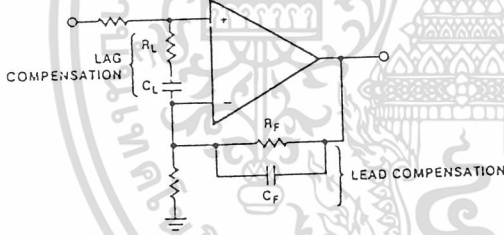


Figure 1. Non-Inverting Configuration

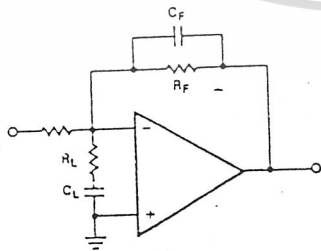


Figure 2. Inverting Configuration

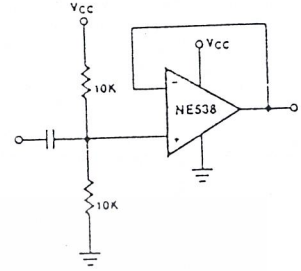


Figure 3. Voltage Follower with Single Power Source

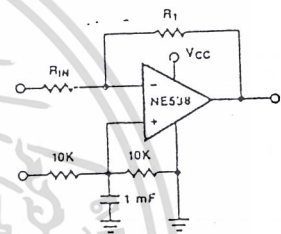


Figure 4. Inverting Amp With Single Power Supply

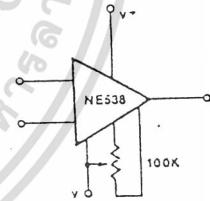
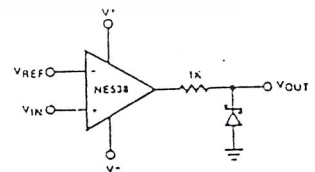


Figure 5. Offset Adjust Circuit



All resistor values are in ohms.

Figure 6. Voltage Comparator

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

PRELIMINARY

80V/2.5A Peak, High Frequency Full Bridge FET Driver

April 1994

Features

- Drives N-Channel FET Full Bridge Including High Side Chop Capability
- Bootstrap Supply Max Voltage to 95VDC
- Drives 1000pF Load at 1MHz in Free Air at +50°C with Rise and Fall Times of Typically 10ns
- User-Programmable Dead Time,
- Charge-Pump and Bootstrap Maintain Upper Bias Supplies
- DIS (Disable) Pin Pulls Gates Low
- Input Logic Thresholds Compatible with 5V to 15V Logic Levels
- Very Low Power Consumption
- Undervoltage Protection

Applications

- Medium/Large Voice Coil Motors
- Full Bridge Power Supplies
- Class D Audio Power Amplifiers
- High Performance Motor Controls
- Noise Cancellation Systems
- Battery Powered Vehicles
- Peripherals
- U.P.S.

Description

The HIP4080A is a high frequency, medium voltage Full Bridge N-Channel FET driver IC, available in 20 lead plastic SOIC and DIP packages. The HIP4080A includes an input comparator, used to facilitate the "hysteresis" and PWM modes of operation. Its HEN (high enable) lead can force current to freewheel in the bottom two external power MOSFETs, maintaining the upper power MOSFETs off. Since it can switch at frequencies up to 1MHz, the HIP4080A is well suited for driving Voice Coil Motors, switching amplifiers in class D high-frequency switching audio amplifiers and power supplies.

HIP4080A can also drive medium voltage brush motors, and two HIP4080As can be used to drive high performance stepper motors, since the short minimum "on-time" can provide fine micro-stepping capability.

Short propagation delays of approximately 55ns maximizes control loop crossover frequencies and dead-times which can be adjusted to near zero to minimize distortion, resulting in precise control of the driven load.

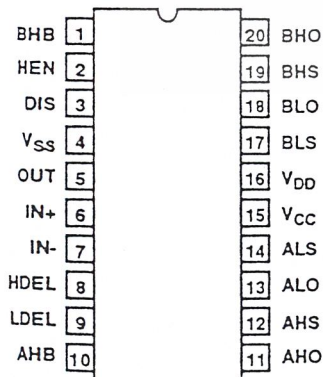
The similar HIP4081 IC allows independent control of all 4 FETs in an Full Bridge configuration.

Ordering Information

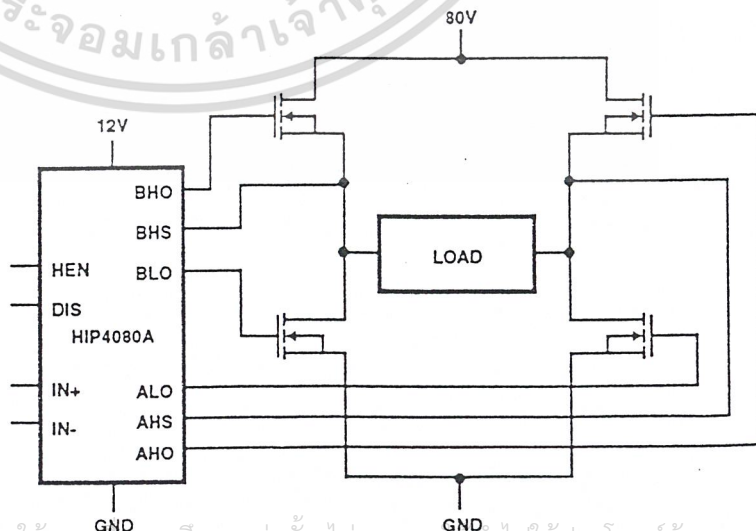
PART NUMBER	TEMPERATURE RANGE	PACKAGE
HIP4080AIP	-40°C to +85°C	20 Lead Plastic DIP
HIP4080AIB	-40°C to +85°C	20 Lead Plastic SOIC (W)
HIP4080AIW	-40°C to +85°C	Wafer
HIP4080AIY	-40°C to +85°C	Die

Pinout

HIP4080A (PDIP, SOIC)
TOP VIEW



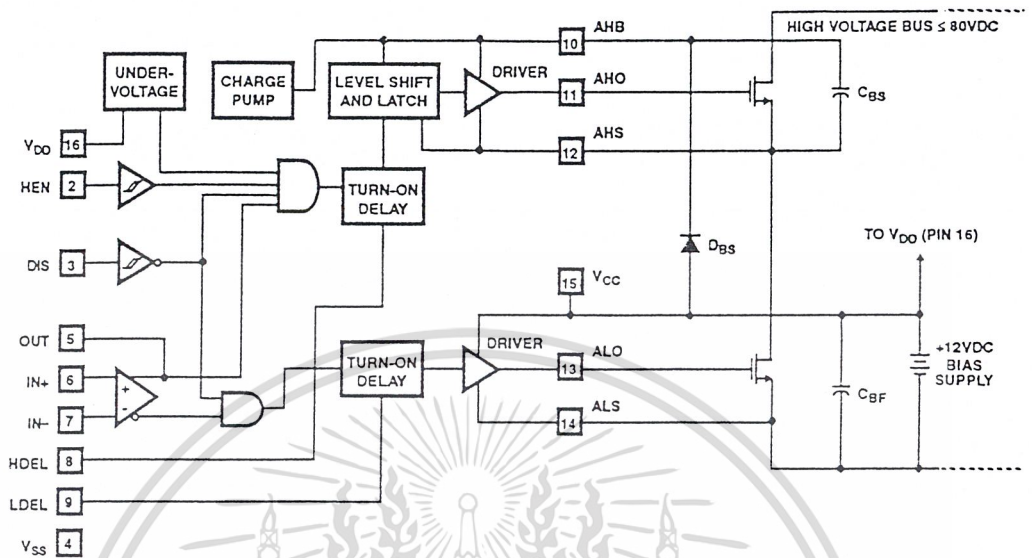
Application Block Diagram



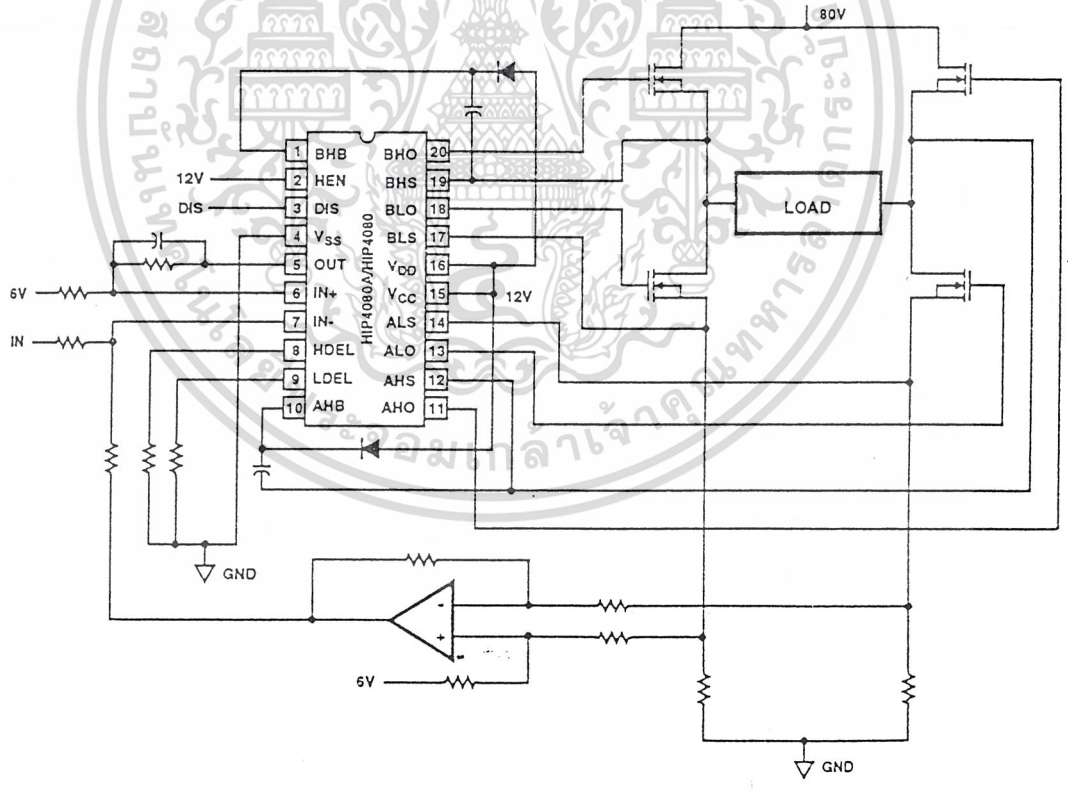
เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

HIP4080A

Functional Block Diagram (1/2 HIP4080A)



Typical Application (Hysteresis Mode Switching)



เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Specifications HIP4080A

Absolute Maximum Ratings

Supply Voltage, V_{DD} and V_{CC}	-0.3V to 16V
Logic I/O Voltages	-0.3V to $V_{DD} + 0.3V$
Voltage on AHS, BHS	-6.0V (Transient) to 88V
Voltage on ALS, BLS	-2.0V (Transient) to +2.0V (Transient)
Voltage on AHB, BHB	$V_{AHS, BHS} - 0.3V$ to $V_{AHS, BHS} + 16V$, or 95V whichever is less
Voltage on ALO, BLO	$V_{ALS, BLS} - 0.3V$ to $V_{CC} + 0.3V$
Voltage on AHO, BHO	$V_{AHS, BHS} - 0.3V$ to $V_{AHB, BHB} + 0.3V$
Input Current, HDEL and LDEL	-5mA to 0mA
Phase Slew Rate	20V/ns

NOTE: All Voltages relative to pin 4, V_{SS} , unless otherwise specified.

Thermal Information

Thermal Resistance	θ_{JA}
SOIC Package	+85°C/W
DIP Package	+75°C/W
Maximum Power Dissipation at +85°C	
SOIC Package	470mW
DIP Package	530mW
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Operating Max. Junction Temperature	+125°C
Lead Temperature (Soldering 10s)	+300°C (For SOIC - Lead Tips Only)

CAUTION: Stresses above those listed in "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. This is a stress only rating and operation of the device at these or any other conditions above those indicated in the operational sections of this specification is not implied.

Operating Conditions

Supply Voltage, V_{DD} and V_{CC}	+9.5V to +15V	Voltage on AHB, BHB	$V_{AHS, BHS} + 5V$ to $V_{AHS, BHS} + 15V$
Voltage on ALS, BLS	-1.0V to +1.0V	Input Current, HDEL and LDEL	-500 μ A to -50 μ A
Voltage on AHS, BHS	-1V to 80V	Operating Ambient Temperature Range	-40°C to +85°C

Electrical Specifications $V_{DD} = V_{CC} = V_{AHB} = V_{BHB} = 12V$, $V_{SS} = V_{ALS} = V_{BLS} = V_{AHS} = V_{BHS} = 0V$, $R_{HDEL} = R_{LDEL} = 100K$, and $T_A = +25^\circ C$, Unless Otherwise Specified

PARAMETERS	SYMBOL	TEST CONDITIONS	$T_J = +25^\circ C$			$T_J = -40^\circ C$ TO +125 $^\circ C$		UNITS
			MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
SUPPLY CURRENTS AND CHARGE PUMPS								
V_{DD} Quiescent Current	I_{DD}	$I_N = 2.5V$, Other Inputs = 0V	8	11	14	7	14	mA
V_{DD} Operating Current	I_{DDO}	Outputs switching $f = 500kHz$, No Load	9	12	15	8	15	mA
V_{CC} Quiescent Current	I_{CC}	$I_N = 2.5V$, Other Inputs = 0V, $I_{ALO} = I_{BLO} = 0$	-	25	80	-	100	μ A
V_{CC} Operating Current	I_{CCO}	$f = 500kHz$, No Load	1	1.25	2.0	0.8	3	mA
AHB, BHB Quiescent Current - Opump Output Current	I_{AHB}, I_{BHB}	$I_N = 2.5V$, Other Inputs = 0V, $I_{AHO} =$ $I_{BHO} = 0$, $V_{DD} = V_{CC} = V_{AHB} = V_{BHB} = 10V$	-50	-25	-11	-60	-10	μ A
AHB, BHB Operating Current	I_{AHBO}, I_{BHBO}	$f = 500kHz$, No Load	0.62	1.2	1.5	0.5	1.9	mA
AHS, BHS, AHB, BHB Leakage Current	I_{HLK}	$V_{AHS} = V_{BHS} = V_{AHB} = V_{BHB} = 95V$	-	0.02	1.0	-	10	μ A
AHB-AHS, BHB-BHS Opump Output Voltage	$V_{AHB} - V_{AHS}$ $V_{BHB} - V_{BHS}$	$I_{AHB} = I_{AHS} = 0$, No Load	11.5	12.6	14.0	10.5	14.5	V
INPUT COMPARATOR PINS: IN+, IN-, OUT								
Offset Voltage	V_{OS}	Over Common Mode Voltage Range	-10	0	+10	-15	+15	mV
Input Bias Current	I_B		0	0.5	2	0	4	μ A
Input Offset Current	I_{OS}		-1	0	+1	-2	+2	μ A
Input Common Mode Voltage Range	CMVR		1	-	$V_{DD} - 1.5$	1	$V_{DD} - 1.5$	V
Voltage Gain	AVOL		10	25	-	10	-	V/mV
OUT High Level Output Voltage	V_{OH}	$I_{N+} > I_{N-}$, $I_{OH} = -250\mu A$	$V_{DD} - 0.4$	-	-	$V_{DD} - 0.5$	-	V
OUT Low Level Output Voltage	V_{OL}	$I_{N+} < I_{N-}$, $I_{OL} = +250\mu A$	-	-	0.4	-	0.5	V
Low Level Output Current	I_{OL}	$V_{OUT} = 6V$	6.5	14	19	6	20	mA
High Level Output Current	I_{OH}	$V_{OUT} = 6V$	-17	-10	-3	-20	-2.5	mA
INPUT PINS: DIS								
Low Level Input Voltage	V_{IL}	Full Operating Conditions	-	-	1.0	-	0.8	V
High Level Input Voltage	V_{IH}	Full Operating Conditions	2.5	-	-	2.7	-	V
Input Voltage Hysteresis			-	35	-	-	-	mV
Low Level Input Current	I_{IL}	$V_{IN} = 0V$, Full Operating Conditions	-130	-100	-75	-135	-65	μ A
High Level Input Current	I_{IH}	$V_{IN} = 5V$, Full Operating Conditions	-1	-	+1	-10	+10	μ A

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Specifications HIP4080A

Electrical Specifications $V_{DD} = V_{CC} = V_{AHB} = V_{BHB} = 12V$, $V_{SS} = V_{ALS} = V_{BLS} = V_{AHS} = V_{BHS} = 0V$, $R_{HDEL} = R_{LDEL} = 100K$, and $T_A = +25^\circ C$, Unless Otherwise Specified (Continued)

PARAMETERS	SYMBOL	TEST CONDITIONS	$T_J = +25^\circ C$			$T_J = -40^\circ C$ TO $+125^\circ C$		UNITS
			MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
INPUT PINS: HEN								
Low Level Input Voltage	V_{IL}	Full Operating Conditions	-	-	1.0	-	0.8	V
High Level Input Voltage	V_{IH}	Full Operating Conditions	2.5	-	-	2.7	-	V
Input Voltage Hysteresis			-	35	-	-	-	mV
Low Level Input Current	I_{IL}	$V_{IN} = 0V$, Full Operating Conditions	-260	-200	-150	-270	-130	μA
High Level Input Current	I_{IH}	$V_{IN} = 5V$, Full Operating Conditions	-1	-	+1	-10	+10	μA
TURN-ON DELAY PINS: LDEL AND HDEL								
LDEL, HDEL Voltage	V_{HDEL}	$I_{HDEL} = I_{LDEL} = -100\mu A$	4.9	5.1	5.3	4.8	5.4	V
GATE DRIVER OUTPUT PINS: ALO, BLO, AHO, AND BHO								
Low Level Output Voltage	V_{OL}	$I_{OUT} = 100mA$	0.7	0.85	1.0	0.5	1.1	V
High Level Output Voltage	$V_{CC} - V_{OH}$	$I_{OUT} = -100mA$	0.8	0.95	1.1	0.5	1.2	V
Peak Pullup Current	I_{O+}	$V_{OUT} = 0V$	1.7	2.6	3.8	1.4	4.1	A
Peak Pulldown Current	I_{O-}	$V_{OUT} = 12V$	1.7	2.4	3.3	1.3	3.6	A
Under Voltage, Rising Threshold	UV+		8.1	8.8	9.4	8.0	9.5	V
Under Voltage, Falling Threshold	UV-		7.6	8.3	8.9	7.5	9.0	V
Under Voltage, Hysteresis	HYS		0.25	0.4	0.65	0.2	0.7	V

Switching Specifications $V_{DD} = V_{CC} = V_{AHB} = V_{BHB} = 12V$, $V_{SS} = V_{ALS} = V_{BLS} = V_{AHS} = V_{BHS} = 0V$, $R_{HDEL} = R_{LDEL} = 10K$, $C_L = 1000pF$, and $T_A = +25^\circ C$, Unless Otherwise Specified

PARAMETERS	SYMBOL	TEST CONDITIONS	$T_J = +25^\circ C$			$T_J = -40^\circ C$ TO $+125^\circ C$		UNITS
			MIN	TYP	MAX	MIN	MAX	
Lower Turn-off Propagation Delay (IN+/IN- to ALO/BLO)	T_{LPHL}		-	40	70	-	90	ns
Upper Turn-off Propagation Delay (IN+/IN- to AHO/BHO)	T_{HPHL}		-	50	80	-	110	ns
Lower Turn-on Propagation Delay (IN+/IN- to ALO/BLO)	T_{LPLH}		-	40	70	-	90	ns
Upper Turn-on Propagation Delay (IN+/IN- to AHO/BHO)	T_{HPLH}		-	70	110	-	140	ns
Rise Time	T_R		-	10	25	-	35	ns
Fall Time	T_F		-	10	25	-	35	ns
Turn-on Input Pulse Width	$T_{PWIN-ON}$		50	-	-	50	-	ns
Turn-off Input Pulse Width	$T_{PWIN-OFF}$		40	-	-	40	-	ns
Disable Turn-off Propagation Delay (DIS - Lower Outputs)	T_{DISLOW}		-	45	75	-	95	ns
Disable Turn-off Propagation Delay (DIS - Upper Outputs)	$T_{DISHIGH}$		-	55	85	-	105	ns
Disable to Lower Turn-on Propagation Delay (DIS - ALO and BLO)	T_{DPLH}		-	45	70	-	90	ns
Refresh Pulse Width (ALO and BLO)	T_{REF-PW}		240	380	500	200	600	ns
Disable to Upper Enable (DIS - AHO and BHO)	T_{UEN}		-	480	630	-	750	ns
HEN-AHO, BHO Turn-off, Propagation Delay	$T_{HEN-PHL}$	$R_{HDEL} = R_{LDEL} = 10K$	-	40	70	-	90	ns
HEN-AHO, BHO Turn-on, Propagation Delay	$T_{HEN-PLH}$	$R_{HDEL} = R_{LDEL} = 10K$	-	60	90	-	110	ns

TRUTH TABLE

INPUT				OUTPUT			
IN+ > IN-	HEN	UV	DIS	ALO	AHO	BLO	BHO
X	X	X	1	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	1	0
X	X	1	X	0	0	0	0

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

HIP4080A

Pin Descriptions

PIN NUMBER	SYMBOL	DESCRIPTION
1	BHB	B High-side Bootstrap supply. External bootstrap diode and capacitor are required. Connect cathode of bootstrap diode and positive side of bootstrap capacitor to this pin. Internal charge pump supplies 30 μ A out of this pin to maintain bootstrap supply. Internal circuitry clamps the bootstrap supply to approximately 12.8V.
2	HEN	High-side Enable input. Logic level input that when low overrides IN+/IN- (Pins 6 and 7) to put AHO and BHO drivers (Pins 11 and 20) in low output state. When HEN is high AHO and BHO are controlled by IN+/IN- inputs. The pin can be driven by signal levels of 0V to 15V (no greater than V _{DD}). An internal 100 μ A pull-up to V _{DD} will hold HEN high, so no connection is required if high-side and low-side outputs are to be controlled by IN+/IN- inputs.
3	DIS	DISable input. Logic level input that when taken high sets all four outputs low. DIS high overrides all other inputs. When DIS is taken low the outputs are controlled by the other inputs. The pin can be driven by signal levels of 0V to 15V (no greater than V _{DD}). An internal 100 μ A pull-up to V _{DD} will hold DIS high if this pin is not driven.
4	V _{SS}	Chip negative supply, generally will be ground.
5	OUT	OUTput of the input control comparator. This output can be used for feedback and hysteresis.
6	IN+	Noninverting input of control comparator. If IN+ is greater than IN- (Pin 7) then ALO and BHO are low level outputs and BLO and AHO are high level outputs. If IN+ is less than IN- then ALO and BHO are high level outputs and BLO and AHO are low level outputs. DIS (Pin 3) high level will override IN+/IN- control for all outputs. HEN (Pin 2) low level will override IN+/IN- control of AHO and BHO. When switching in four quadrant mode, dead time in a half bridge leg is controlled by HDEL and LDEL (Pins 8 and 9).
7	IN-	Inverting input of control comparator. See IN+ (Pin 6) description.
8	HDEL	High-side turn-on DELay. Connect resistor from this pin to V _{SS} to set timing current that defines the turn-on delay of both high-side drivers. The low-side drivers turn-off with no adjustable delay, so the HDEL resistor guarantees no shoot-through by delaying the turn-on of the high-side drivers. HDEL reference voltage is approximately 5.1V.
9	LDEL	Low-side turn-on DELay. Connect resistor from this pin to V _{SS} to set timing current that defines the turn-on delay of both low-side drivers. The high-side drivers turn-off with no adjustable delay, so the LDEL resistor guarantees no shoot-through by delaying the turn-on of the low-side drivers. LDEL reference voltage is approximately 5.1V.
10	AHB	A High-side Bootstrap supply. External bootstrap diode and capacitor are required. Connect cathode of bootstrap diode and positive side of bootstrap capacitor to this pin. Internal charge pump supplies 30 μ A out of this pin to maintain bootstrap supply. Internal circuitry clamps the bootstrap supply to approximately 12.8V.
11	AHO	A High-side Output. Connect to gate of A High-side power MOSFET.
12	AHS	A High-side Source connection. Connect to source of A High-side power MOSFET. Connect negative side of bootstrap capacitor to this pin.
13	ALO	A Low-side Output. Connect to gate of A Low-side power MOSFET.
14	ALS	A Low-side Source connection. Connect to source of A Low-side power MOSFET.
15	V _{CC}	Positive supply to gate drivers. Must be same potential as V _{DD} (Pin 16). Connect to anodes of two bootstrap diodes.
16	V _{DD}	Positive supply to lower gate drivers. Must be same potential as V _{CC} (Pin 15). De-couple this pin to V _{SS} (Pin 4).
17	BLS	B Low-side Source connection. Connect to source of B Low-side power MOSFET.
18	BLO	B Low-side Output. Connect to gate of B Low-side power MOSFET.
19	BHS	B High-side Source connection. Connect to source of B High-side power MOSFET. Connect negative side of bootstrap capacitor to this pin.
20	BHO	B High-side Output. Connect to gate of B High-side power MOSFET.

HIP4080A

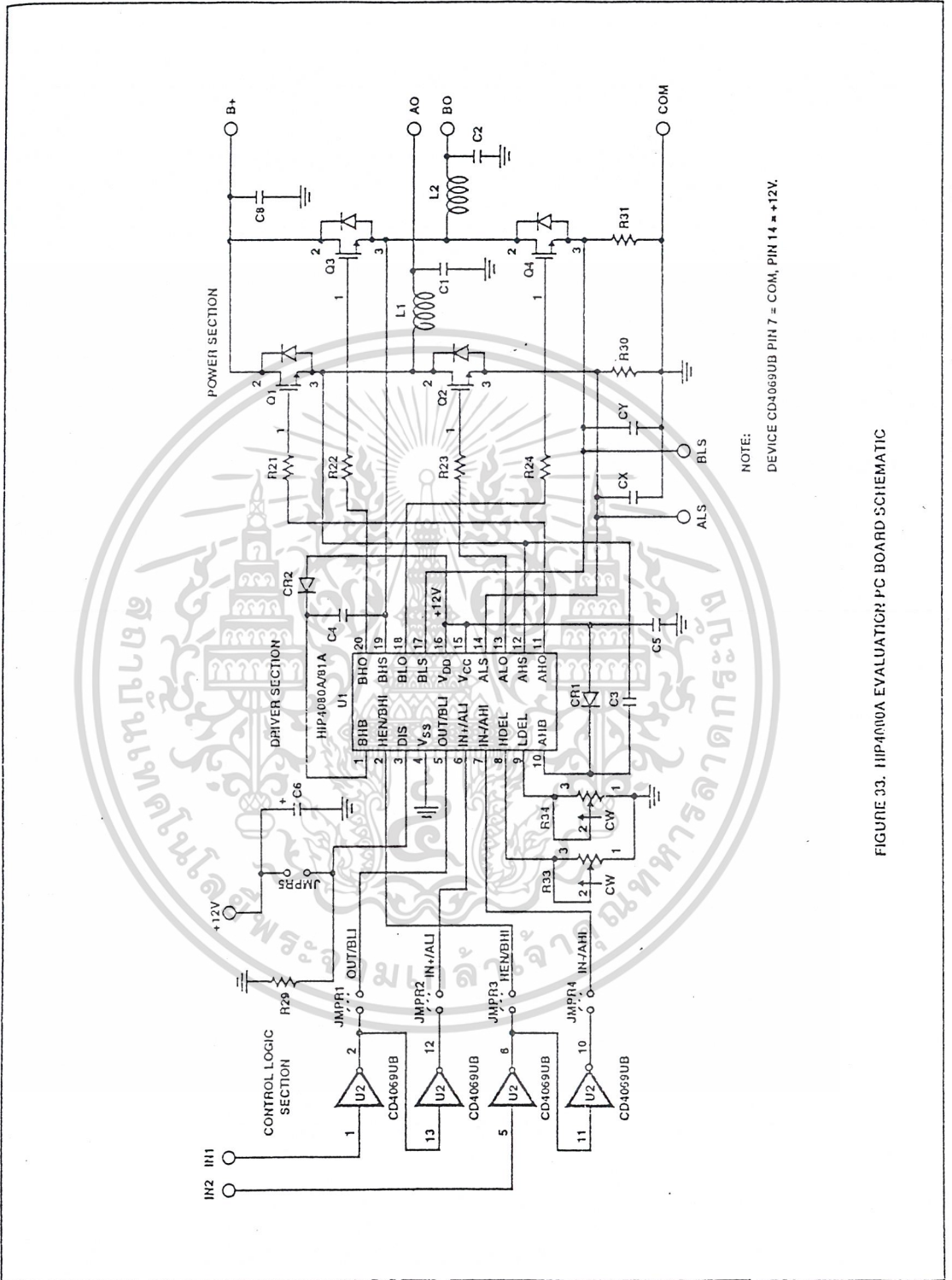


FIGURE 33. HIP4080A EVALUATION PCB BOARD SCHEMATIC

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Application Note 9525

HIP4080EVAL2 Parts List

LINE ITEM NO.	QTY PER PCB	REFERENCE DESIGNATION	DESCRIPTION	RETAILER				MANUFACTURER	
				NAME	STOCK NO.	CATALOG	PAGE	NAME	PART NO.
0	1	P.C.B.	Bare Circuit Board	EPC	HIP4080A Eval2	-	-	E.P.C.	Rev C MK95
1	9	C1, C4, C13, C15, C16, C29, C30, C32, C35	0.22µF 63V Z5U 20% Mono Cer	Digikey	P4918	951	219	Panasonic	ECU-S1J224MEA
2	6	C17, C18, C20, C21, C22, C23	0.1µF 100V X7R 10% Mono Cer	Digikey	P4910	955	225	Panasonic	ECU-S2A104KBA
3	1	C2	100µF 50V Electro	Digikey	P6268	951	181	Panasonic	ECE-A1HU101
4	1	C5	1µF 50V Electro	Digikey	P6260	951	181	Panasonic	ECE-A1HU010
5	1	C6	47pF 10% NPO Cer Disk	Digikey	P4452	951	212	Panasonic	ECC-F2A470JCE
6	1	C7	100µF 10V Electro	Digikey	P6214	951	181	Panasonic	ECE-A1AU101
7	1	C8	470µF 50V Switch-grade Elect	Digikey	P5772	951	187	Panasonic	ECA-1HFQ471
8	1	C9	0.1µF 50V Radial Film	Digikey	P4525	951	205	Panasonic	ECQ-V1H104JL
9	1	C10	330pf 63V COG Mono Cer	Digikey	P4806	951	218	Panasonic	ECU-S1J331JCA
10	1	C11	100µF 16V Electro	Digikey	P6227	951	181	Panasonic	ECE-A1CU101
11	2	C12, C28	0.001µF 100V YP5 Cer Disk	Digikey	P4185	951	212	Panasonic	ECK-F2A102KBE
12	2	C33, C34	1µF 100V Radial Film	Digikey	EF1105	951	208	Panasonic	ECQ-E1105KF
13	1	C14	1µF 63V Radial Film	Digikey	P4548	951	205	Panasonic	ECQ-V1J105JM
14	2	C24, C25	0.001µF 100V Radial Film	Digikey	P4785	951	203	Panasonic	ECQ-B1102JF
15	2	C26, C27	3.9µF 100V Radial Film	Digikey	EF1395	951	208	Panasonic	ECQ-E1395KF
16	1	C31	82µF 16V Switch-grade Elect	Digikey	P5665	951	186	Panasonic	ECA-1CFQ820
17	1	C36	1µF 1210 50V Chip Cap	Digikey	-	-	-	Panasonic	-
18	1	D1	LED	Digikey	P300	951	137	Panasonic	LN21RPHL
19	1	D2	1N4148	Newark	1N4148	113	83	-	-
20	2	D3, D4	UF4002TR	Mouser	UF4002TR	-	-	Diodes, Inc.	-
21	1	F1 HOLDER	5X20mm Fuse Holder	Mouser	534-3527	-	-	-	-
22	1	F1	10A 250V FAST BLOW	Digikey	F955-ND	955	319	-	-
23	1	J1	RCA Receptacle, PC Mount	Mouser	161-4214	-	-	-	-
24	3	J2, J4, J6	Red Binding Post	Bisco	-	-	-	Keystone	7006
25	3	J3, J5, J7	Black Binding Post	Bisco	-	-	-	Keystone	7007
26	2	L1, L2	16.5µH (19t #20 on T106-3)	Amidon	-	-	-	Amidon	T106-3
27	2	L3, L4	11.5µH (2t #20 on T68-15)	Amidon	-	-	-	Amidon	T68-15
28	1	P1	100K Trimpot	Digikey	36C15	951	250	Panasonic	EVN-36CA00B15
29	2	P2, P4	1K Trimpot	Digikey	36C13	951	250	Panasonic	EVN-36CA00B13
30	1	P3	10K Trimpot	Digikey	36C14	951	250	Panasonic	EVN-36CA00B14
31	1	Q1	J112 N-Channel JFET	Allied	J112	113	32	Motorola	J112
32	4	Q2, Q3, Q4, Q5	RFP22N10	Harris	SOAR	-	-	Harris	-
33	4	Q2, Q3, Q4, Q5	Heat Sinks	Digikey	HS104-1	951	108	-	-
34	4	Q2, Q3, Q4, Q5	6-32 X 3/8" Machine Screws	Digikey	H356	951	301	-	-
35	4	Q2, Q3, Q4, Q5	Nylon washer, #6	Digikey	3370K-ND	951	299	-	-
36	4	Q2, Q3, Q4, Q5	Nut, 6-32 Hex	Digikey	H220	951	301	-	-
37	2	R3, R15	2K 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	2.0KQBK	951	226	Yageo	-
38	4	R4, R38, R39, R42	4.7K 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	4.7KQBK	951	226	Yageo	-
39	4	R36, R37, R40, R41	4.64K 1/4W 1% MF Resist	Digikey	4.64QBK	951	226	Yageo	-
40	3	R9, R13, R21	3.3K 1/4W 1% MF Resist	Digikey	3.3KQBK	951	226	Yageo	-

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษานานาชาติ ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า

ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

HIP4080A

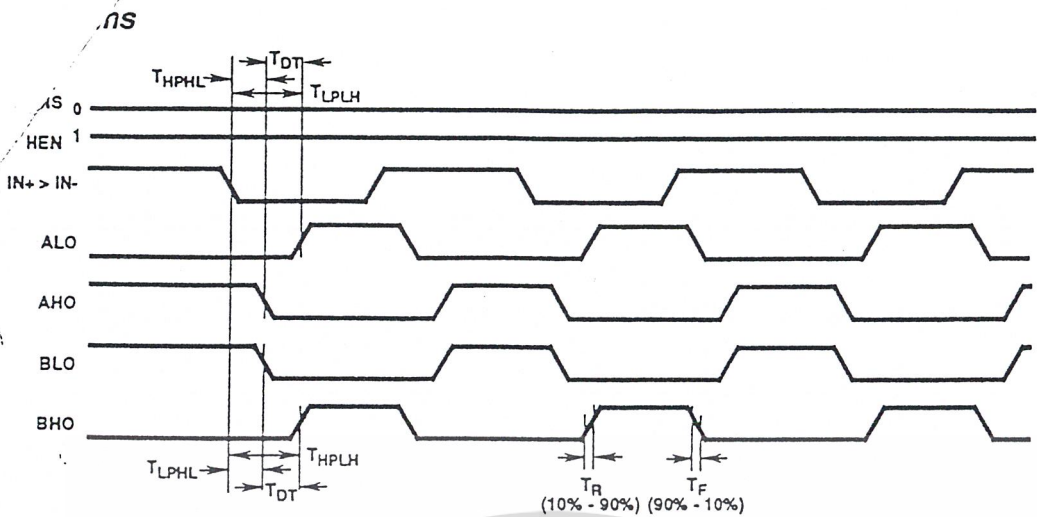


FIGURE 1. BISTATE MODE

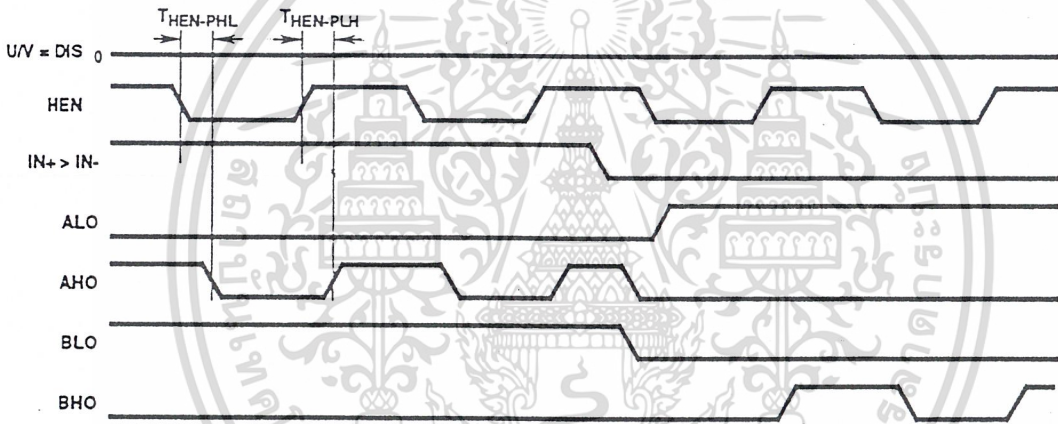


FIGURE 2. HIGH SIDE CHOP MODE

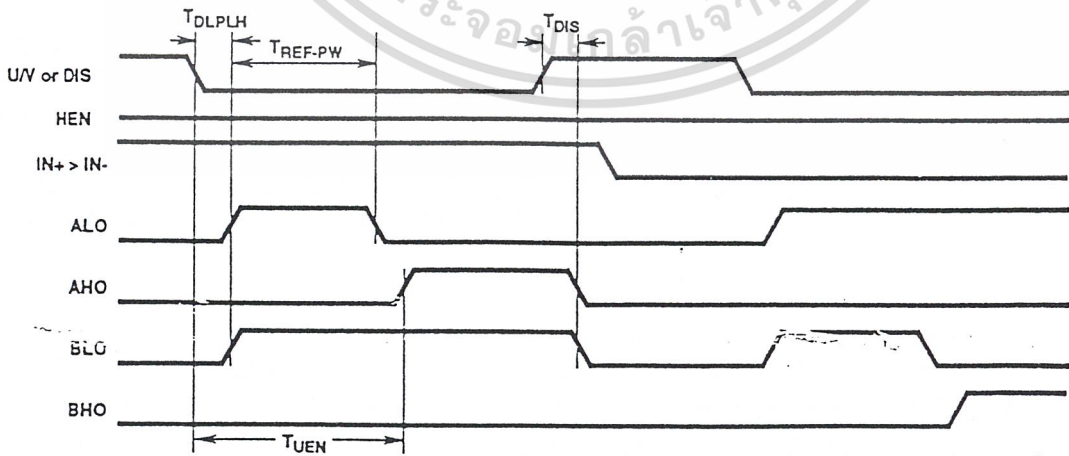


FIGURE 3. DISABLE FUNCTION

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

Application Note 9525

HIP4080EVAL2 Parts List

LINE ITEM NO.	QTY PER PCB	REFERENCE DESIGNATION	DESCRIPTION	RETAILER				MANUFACTURER	
				NAME	STOCK NO.	CATALOG	PAGE	NAME	PART NO.
41	4	R6, R10, R11, R17	10K 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	10KQBK	951	226	Yageo	-
42	1	R7	47K 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	47KQBK	951	226	Yageo	-
43	1	R8	NOT INSTALLED	-	-	-	-	-	-
44	2	R25, R26	46.4K 1/4W 1% MF Resist	Digikey	46.4KQBK	951	226	Yageo	-
45	2	R12, R19	470K 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	470KQBK	951	226	Yageo	-
46	3	R14, R18, R43	1K 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	1KQBK	951	226	Yageo	-
47	1	R16	18K 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	18KQBK	951	226	Yageo	-
48	1	R20	1M 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	1MQBK	951	226	Yageo	-
49	1	R22	20K 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	20KQBK	951	226	Yageo	-
50	1	R23	6.8K 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	6.8KQBK	951	226	Yageo	-
51	1	R24	100K 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	100KQBK	951	226	Yageo	-
52	4	R28, R29, R30, R31	10 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	10.0QBK	951	226	Yageo	-
53	1	R32	3.9Ω 5% 3W	Digikey	P3.9W-3	951	227	Yageo	-
54	1	R33	0.1 3W 5% WW Resistor	Digikey	SC3D-0.1	951	228	Yageo	-
55	2	R34, R35	200K, 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	200KQBK	951	226	Yageo	-
56	1	R44	20K, 1/4W CF 5% Resistor	Digikey	20KQBK	951	226	Yageo	-
57	1	S1	Push Button Switch	Mouser	102-1271	-	-	C&K	8121SD9AV2GE
58	1	U1	CA3290E	Harris	CA3290E	SOAR	-	-	-
59	1	U2	CD4013BE	Harris	CD4013BE	SOAR	-	-	-
60	1	U3	LM2931CT	Digikey	9192B-ND	951	89	National	-
61	1	U5	CA5470E	Harris	CA5470E	SOAR	-	-	-
62	1	U7	HIP4080AIP	Harris	HIP4080AIP	SOAR	-	-	-
63	1	U9	CD4069UBE	Harris	CD4069UBE	SOAR	-	-	-
64	1	U10	78L06 Voltage Reg.	Digikey	NJM78L06A	-	-	Motorola	-
65	1	SU1	8-pin IC Mach. Screw Sockets	Digikey	AE7208	951	75	Assmann	-
66	3	SU2, SU5, SU9	14-pin IC Mach. Screw Sockets	Digikey	AE7214	951	75	Assmann	-
67	1	SU7	20-pin IC Mach. Screw Sockets	Digikey	AE7220	951	75	Assmann	-
68	4	Standoff	Board Standoff	Newark	81N2587	113	1226	-	-

All Harris Semiconductor products are manufactured, assembled and tested under ISO9000 quality systems certification.

Harris Semiconductor products are sold by description only. Harris Semiconductor reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Accordingly, the reader is cautioned to verify that data sheets are current before placing orders. Information furnished by Harris is believed to be accurate and reliable. However, no responsibility is assumed by Harris or its subsidiaries for its use; nor for any infringements of patents or other

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้

HIP4080A

Typical Performance Curves $V_{DD} = V_{CC} = V_{AHB} = V_{BHB} = 12V$, $V_{SS} = V_{ALS} = V_{BLS} = V_{AHS} = V_{BHS} = 0V$, $R_{HOEL} = R_{LDEL}$, $100K$, and $T_A = +25^\circ C$, Unless Otherwise Specified (Continued)

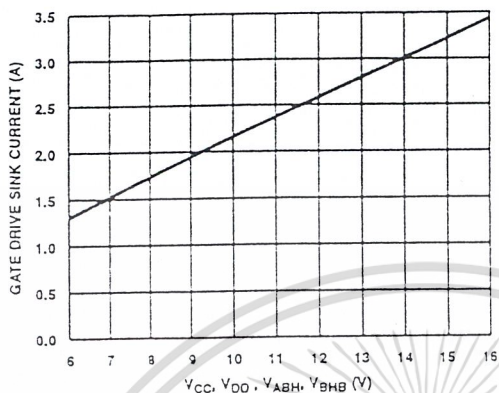


FIGURE 28. PEAK PULLUP CURRENT I_{OP} vs SUPPLY VOLTAGE

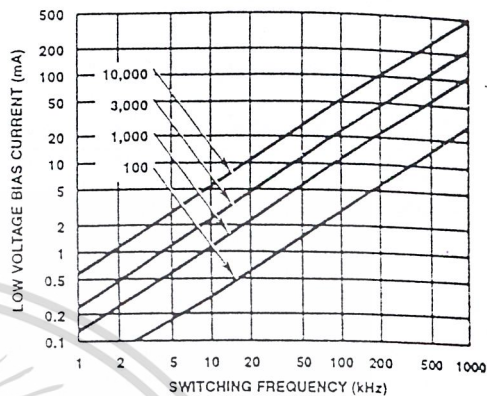


FIGURE 29. LOW VOLTAGE BIAS CURRENT I_{BO} AND I_{CC} (LESS QUIESCENT COMPONENT) vs FREQUENCY AND GATE LOAD CAPACITANCE

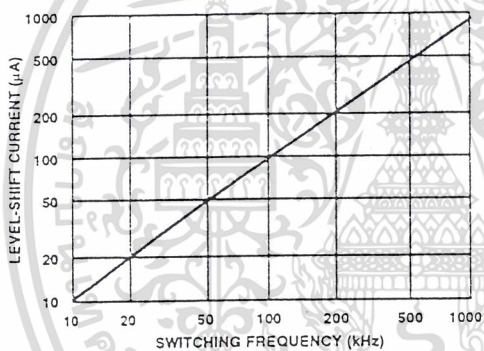


FIGURE 30. HIGH VOLTAGE LEVEL-SHIFT CURRENT vs FREQUENCY AND BUS VOLTAGE

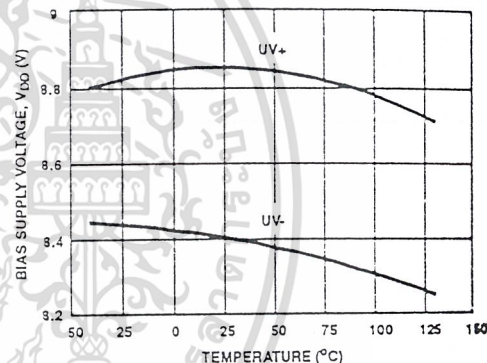


FIGURE 31. UNDERVOLTAGE LOCKOUT vs TEMPERATURE

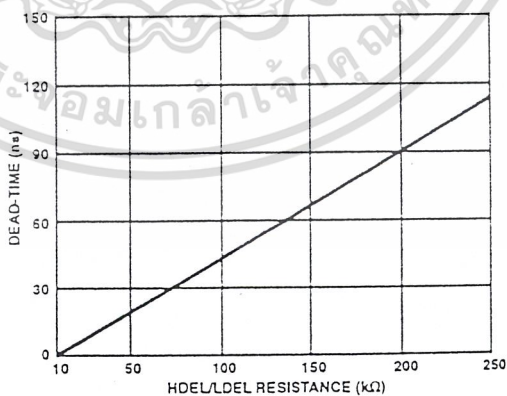


FIGURE 32. MINIMUM DEAD-TIME vs DEL RESISTANCE

เอกสารนี้เป็นเอกสารที่สงวนไว้สำหรับการใช้งานเพื่อการศึกษาเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปใช้ประโยชน์ด้านการค้า
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งห้ามมิให้ดัดแปลงเนื้อหาและต้องอ้างอิงถึงเจ้าของเอกสารทุกครั้งที่มีการนำไปใช้